

PCT/JP2004/010411

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

09. 8. 2004

REC'D 30 SEP 2004

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2003年 7月29日

出 願 番 号
Application Number: 特願2003-282162
[ST. 10/C]: [JP2003-282162]

出 願 人
Applicant(s): 浜松ホトニクス株式会社

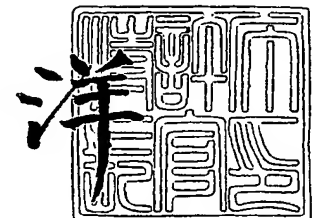
PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

2004年 9月16日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 2003-0190
【提出日】 平成15年 7月29日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 27/14
【発明者】
 【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社
社内
 【氏名】 柴山 勝己
【特許出願人】
 【識別番号】 000236436
 【氏名又は名称】 浜松ホトニクス株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100088155
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 長谷川 芳樹
【選任した代理人】
 【識別番号】 100092657
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 寺崎 史朗
【選任した代理人】
 【識別番号】 100124291
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 石田 悟
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 014708
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

第 1 導電型の半導体基板と、

前記半導体基板の第 1 面側における表層に設けられ、第 2 導電型の不純物半導体領域と

、
前記半導体基板の第 2 面における前記不純物半導体領域に対向する領域に形成され、被検出光が入射する凹部と、

前記第 2 面上に設けられ、前記被検出光を前記凹部へと透過させる樹脂からなるとともに、表面が実質的に平坦な被覆層と、

前記被覆層の前記表面上に設けられ、前記被検出光を前記被覆層へと透過させる窓板と

、
を備えることを特徴とする裏面入射型光検出素子。

【請求項 2】

前記被覆層は、前記第 2 面上に設けられた第 1 樹脂層と、前記第 1 樹脂層上に設けられ、前記第 1 樹脂層と反対側の面が実質的に平坦な第 2 樹脂層とから構成されており、

前記第 1 樹脂層は、前記第 2 面の前記凹部上に設けられた部分が、前記凹部の外縁部上に設けられた部分に対して窪んでいることを特徴とする請求項 1 に記載の裏面入射型光検出素子。

【請求項 3】

前記半導体基板の前記第 1 面上に設けられ、前記半導体基板を支持する支持膜を備えることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の裏面入射型光検出素子。

【請求項 4】

前記支持膜を貫通するとともに、一端が前記不純物半導体領域と電氣的に接続された充填電極を備えることを特徴とする請求項 3 に記載の裏面入射型光検出素子。

【請求項 5】

前記窓板は、その厚さ方向に垂直な面での断面形状が、少なくとも 1 つの角が切り欠かれた四角形であることを特徴とする請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の裏面入射型光検出素子。

【請求項 6】

前記半導体基板の側面全体に、前記第 1 導電型の不純物が高濃度に添加された高濃度不純物半導体領域が露出していることを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載の裏面入射型光検出素子。

【請求項 7】

前記半導体基板の前記第 2 面側における表層のうち、前記凹部の底面部分に、前記第 1 導電型の不純物が高濃度に添加された高濃度不純物半導体層が設けられていることを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の裏面入射型光検出素子。

【請求項 8】

前記半導体基板の前記外縁部の前記第 2 面側における表層に、前記第 1 導電型の不純物が高濃度に添加された高濃度不純物半導体層が設けられていることを特徴とする請求項 1 ～ 7 のいずれか一項に記載の裏面入射型光検出素子。

【書類名】明細書

【発明の名称】裏面入射型光検出素子

【技術分野】

【0001】

本発明は、裏面入射型光検出素子に関するものである。

【背景技術】

【0002】

図20に示す従来の裏面入射型ホトダイオード100においては、N型シリコン基板101の上面側の表層にP⁺型高濃度不純物半導体領域102及びN⁺型高濃度不純物半導体領域103が形成されている。P⁺型高濃度不純物半導体領域102及びN⁺型高濃度不純物半導体領域103には、それぞれアノード電極104及びカソード電極105が接続されている。両電極104、105上には、半田からなるバンプ電極106が形成されている。また、N型シリコン基板101は、P⁺型高濃度不純物半導体領域102に対応する部分が裏面側から薄板化されている。この薄板化された部分が被検出光の入射部となる。

【0003】

裏面入射型ホトダイオード100は、図20に示すように、フリップチップボンディングによりセラミックパッケージ107に実装される。すなわち、裏面入射型ホトダイオード100のバンプ電極106が、セラミックパッケージ107の底面配線108上に設けられた半田パッド109と接続されている。底面配線108はワイヤボンディングで、出力端子ピン110に電氣的に接続されている。また、セラミックパッケージ107の上面には、窓枠111がロウ材112でシーム溶接されている。窓枠111には、裏面入射型ホトダイオード100の薄板化された部分に対応する位置に開口が形成されており、この開口部分に被検出光を透過させるコバルガラス等の窓板113が設けられている。

【特許文献1】特開平9-219421号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

裏面入射型ホトダイオードにおいては、セラミックパッケージを用いる上記構成では、そのパッケージが大きくなってしまいうという問題がある。

【0005】

一方、特許文献1には、半導体電子部品に対するCSP（チップサイズパッケージ）技術が開示されている。この技術においては、半導体電子部品が作りこまれたウエハの両面を樹脂等の有機材料により封止するとともに、ウエハの一面側に設けられた有機材料にフォトリソグラフィにより開口を形成し、その開口に電極を形成している。

【0006】

しかしながら、上記のCSP技術を裏面入射型ホトダイオードに適用して、そのパッケージを小さくしようとすると、以下の問題を生じる。裏面が樹脂で封止された裏面入射型ホトダイオードにおいては、その樹脂の表面が被検出光の入射面となる。ところが、樹脂表面を被検出光の波長レベルで十分に平坦化することは困難な場合がある。樹脂表面が十分に平坦化されていないと、被検出光の入射面が粗くなり、それゆえ入射面において被検出光が散乱を受けてしまうという問題がある。そして、被検出光が散乱を受けることは、裏面入射型ホトダイオードの感度低下にもつながってしまう。

【0007】

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、パッケージを十分に小さくでき、且つ被検出光の散乱を抑制することができる裏面入射型光検出素子を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記課題を解決するために、本発明による裏面入射型光検出素子は、第1導電型の半導体基板と、半導体基板の第1面側における表層に設けられ、第2導電型の不純物半導体領

域と、半導体基板の第2面における不純物半導体領域に対向する領域に形成され、被検出光が入射する凹部と、第2面上に設けられ、被検出光を凹部へと透過させる樹脂からなるとともに、表面が実質的に平坦な被覆層と、被覆層の表面上に設けられ、被検出光を被覆層へと透過させる窓板と、を備えることを特徴とする。

【0009】

この裏面入射型光検出素子においては、被覆層が設けられていることにより、裏面入射型光検出素子の機械的強度が向上している。機械的強度の向上により、ウエハレベルでのダイシングが可能となるため、チップサイズの裏面入射型光検出素子を得ることができる。これにより、パッケージが十分に小さい裏面入射型光検出素子の実現されている。また、被覆層は、被検出光を透過させる樹脂からなるため、裏面入射型光検出素子の機械的強度を向上させるだけでなく、被検出光に対する透過窓材としても機能することができる。

【0010】

さらに、窓板が被覆層の表面上に設けられている。したがって、窓板の表面が被検出光の入射面となり、入射面における被検出光の散乱が抑制される。また、窓板を設ける際に、被覆層の表面が窓板に押し付けられることにより、窓板と被覆層との界面すなわち被覆層の表面も十分に平坦化される。このため、被覆層の表面における被検出光の散乱も抑制される。よって、高感度な裏面入射型光検出素子の実現される。また、窓板は、裏面入射型光検出素子の機械的強度を一層向上させる。

【0011】

被覆層は、第2面上に設けられた第1樹脂層と、第1樹脂層上に設けられ、第1樹脂層と反対側の面が実質的に平坦な第2樹脂層とから構成されており、第1樹脂層は、第2面の凹部上に設けられた部分が、凹部の外縁部上に設けられた部分に対して窪んでいることが好適である。この場合、製造工程の途中で平コレットを用いても、裏面入射型光検出素子の高感度な光検出が保証される。

【0012】

本発明による裏面入射型光検出素子は、半導体基板の第1面上に設けられ、半導体基板を支持する支持膜を備えることが好適である。この場合、裏面入射型光検出素子の機械的強度が一層向上する。

【0013】

本発明による裏面入射型光検出素子は、支持膜を貫通するとともに、一端が不純物半導体領域と電気的に接続された充填電極を備えることが好適である。この場合、検出信号を裏面入射型光検出素子の外部に容易に取り出すことができる。

【0014】

窓板は、その厚さ方向に垂直な面での断面形状が、少なくとも1つの角が切り欠かれた四角形であることが好適である。この場合、裏面入射型光検出素子のダイシング時におけるチップングの発生が抑制される。

【0015】

半導体基板の側面全体に、第1導電型の不純物が高濃度に添加された高濃度不純物半導体領域が露出していることが好適である。この場合、半導体基板の側面がダイシング等によりダメージを受けている場合であっても、半導体基板の側面付近で発生した不要キャリアを高濃度不純物半導体領域によりトラップすることができ、それゆえ暗電流や雑音を抑えることができる。

【0016】

半導体基板の第2面側における表層のうち、凹部の底面部分に、第1導電型の不純物が高濃度に添加された高濃度不純物半導体層が設けられていることが好適である。この高濃度不純物半導体層は、アキュームレーション層として機能する。これにより、被検出光の入射により発生したキャリアが凹部の底面付近で再結合するのを防ぐことができ、半導体基板の第1面側の表層に設けられた第2導電型の不純物半導体領域の方へキャリアが移動し易くなり、それゆえ感度が向上する。

【0017】

半導体基板の外縁部の第2面側における表層に、第1導電型の不純物が高濃度に添加された高濃度不純物半導体層が設けられていることが好適である。この場合、外縁部の第2面側における表面付近に結晶欠陥が生じている場合であっても、結晶欠陥に起因して発生する暗電流やノイズを高濃度不純物半導体層により抑制することができる。

【発明の効果】

【0018】

本発明によれば、パッケージを十分に小さくでき、且つ被検出光の散乱を抑制することができる裏面入射型光検出素子の実現される。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

以下、図面とともに本発明による裏面入射型光検出素子の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面の寸法比率は、説明のものと必ずしも一致していない。

【0020】

図1は、本発明による裏面入射型光検出素子の第1実施形態を示す断面図である。裏面入射型ホトダイオード1は、裏面側から被検出光を入射し、被検出光の入射によりキャリアを生成し、生成したキャリアを検出信号として上面側から出力するものである。裏面入射型ホトダイオード1は、N型半導体基板10、P⁺型不純物半導体領域11、凹部12、被覆層13、及び窓板14を備えている。N型半導体基板10としては、例えば、リン等のN型不純物が添加されたシリコン基板を用いることができる。N型半導体基板10の不純物濃度は、例えば $10^{12} \sim 10^{15} / \text{cm}^3$ である。また、N型半導体基板10の厚さ t_1 は、例えば $200 \sim 500 \mu\text{m}$ である。

【0021】

N型半導体基板10の上面（第1面）S1側における表層の一部には、P⁺型不純物半導体領域11が形成されている。P⁺型不純物半導体領域11は、ボロン等のP型不純物が添加されており、N型半導体基板10とpn接合を構成している。P⁺型不純物半導体領域11の不純物濃度は、例えば $10^{15} \sim 10^{20} / \text{cm}^3$ である。また、P⁺型不純物半導体領域11の深さは、例えば $0.1 \sim 20 \mu\text{m}$ である。

【0022】

N型半導体基板10の裏面（第2面）S2におけるP⁺型不純物半導体領域11に対向する領域には、凹部12が形成されている。凹部12は、被検出光の入射部となる。凹部12は、裏面S2から上面S1に向かって幅が次第に狭くなる形状をしている。具体的には、凹部12の形状は、例えば裏面S2から上面S1に向かって幅が次第に狭くなる四角錐状又はテーパ状とすることができる。凹部12の深さは、例えば $2 \sim 400 \mu\text{m}$ である。また、凹部12が形成されることにより、N型半導体基板10のうち凹部底面S4及びP⁺型不純物半導体領域11で挟まれた領域は、裏面S2側からの被検出光の入射により発生したキャリアが上面S1側表層に設けられたP⁺型不純物半導体領域11付近まで達し易くなるように、他の領域よりも薄板化されている。また、この薄板化された領域の厚さは、例えば $10 \sim 200 \mu\text{m}$ である。

【0023】

N型半導体基板10の裏面S2上には、被覆層13が設けられている。被覆層13は、N型半導体基板10と後述する窓板14との間に充填されるとともに、N型半導体基板10と窓板14とを光学的に接続している。また、被覆層13は、N型半導体基板10と窓板14とを物理的にも接続している。被覆層13は、裏面S2上に設けられた樹脂層13a（第1樹脂層）と、樹脂層13a上に設けられた樹脂層13b（第2樹脂層）とから構成されている。樹脂層13a、13bには、被検出光に対して透明な樹脂、すなわち被検出光の波長に対して十分な透過率をもつ樹脂が用いられる。このような樹脂として、例えば、エポキシ系、シリコン系、アクリル系若しくはポリイミド系のもの、又はこれらの複合素材からなるものが挙げられる。また、樹脂は接着性を有するものが望ましく、その場合には、N型半導体基板10と窓板14とを接着して強固なものとするため物理的強

度を一層向上させることが可能となる。樹脂層 13a, 13b には、同一の樹脂を用いてもよいし、相異なる樹脂を用いてもよい。相異なる樹脂を用いる場合は、互いに同程度の屈折率を有する樹脂を用いることが望ましい。この被覆層 13 は、裏面 S2 を保護する保護層として機能するとともに、被検出光を凹部 12 へと透過させる透過窓材としても機能する。

【0024】

樹脂層 13a は、凹部 12 上に設けられている部分が、凹部 12 の外縁部 15 上に設けられている部分に対して窪んでいる。すなわち、凹部 12 が形成されている部分に設けられた樹脂層 13a の表面は、凹部 12 の外縁部 15 に設けられた樹脂層 13a の表面よりも N 型半導体基板 10 側に入り込んでいる。樹脂層 13b は、樹脂層 13a と隙間なく密着しており、それゆえ樹脂層 13a の窪みに一致する突出部を樹脂層 13a 側に有する形状をしている。一方で、樹脂層 13b の表面 S3 (樹脂層 13a と反対側の面) の形状は、実質的に平坦である。ここで、外縁部 15 とは、N 型半導体基板 10 のうち凹部 12 を側方から包囲している部分を指す。外縁部 15 を基準とした被覆層 13 の厚さ t_2 は、例えば $1 \sim 200 \mu\text{m}$ 、好ましくは $30 \mu\text{m}$ 程度である。

【0025】

被覆層 13 の表面、すなわち樹脂層 13b の表面 S3 上には、窓板 14 が設けられている。窓板 14 は、被覆層 13 と隙間なく密着している。窓板 14 は、平板状をしており、被検出光の波長に対して十分な透過率をもつ材料からなる。窓板 14 の材料としては、例えば、ガラス又は光学結晶を用いることができる。窓板 14 の材料の具体例としては、コルツ、サファイヤ、コバールガラス等が挙げられる。窓板 14 の厚さは、例えば $0.2 \text{ mm} \sim 1 \text{ mm}$ である。なお、窓板 14 には、AR (anti-reflection) コーティングが施されている。また、窓板 14 は、凹部 12 の外縁部 15 上に設けられている。

【0026】

また、裏面入射型ホトダイオード 1 は、N⁺型高濃度不純物半導体層 21、N⁺型高濃度不純物半導体領域 22、絶縁膜 23、24、アノード電極 25、及びカソード電極 26 を備えている。N⁺型高濃度不純物半導体層 21 は、N 型半導体基板 10 の裏面 S2 側の表層全体に形成されている。N⁺型高濃度不純物半導体層 21 は、N 型不純物が N 型半導体基板 10 よりも高濃度に添加されている。N⁺型高濃度不純物半導体層 21 の不純物濃度は、例えば $10^{15} \sim 10^{20} / \text{cm}^3$ である。また、N⁺型高濃度不純物半導体層 21 の深さは、例えば $0.1 \sim 20 \mu\text{m}$ である。

【0027】

N⁺型高濃度不純物半導体領域 22 は、N 型半導体基板 10 の上面 S1 側における表層に、P⁺型不純物半導体領域 11 と所定の距離を隔てて形成されている。N⁺型高濃度不純物半導体領域 22 は、N⁺型高濃度不純物半導体層 21 と同様に N 型不純物が高濃度に添加されており、後述するカソード電極 26 とのコンタクト層である。N⁺型高濃度不純物半導体領域 22 の不純物濃度は、例えば $10^{15} \sim 10^{20} / \text{cm}^3$ である。また、N⁺型高濃度不純物半導体領域 22 の深さは、例えば $0.1 \sim 30 \mu\text{m}$ である。

【0028】

絶縁膜 23 及び絶縁膜 24 は、それぞれ N 型半導体基板 10 の上面 S1 及び裏面 S2 上に形成されている。絶縁膜 23、24 は、例えば SiO₂ からなる。絶縁膜 23 の厚さは、例えば $0.1 \sim 2 \mu\text{m}$ である。一方、絶縁膜 24 の厚さは、例えば $0.05 \sim 1 \mu\text{m}$ である。また、絶縁膜 23 には、開口 (コンタクトホール) 23a、23b が形成されており、一方の開口 23a は P⁺型不純物半導体領域 11 の部分に、他方の開口 23b は N⁺型高濃度不純物半導体領域 22 の部分に設けられている。

【0029】

絶縁膜 23 上の開口 23a、23b を含む領域には、それぞれアノード電極 25 及びカソード電極 26 が形成されている。これらの電極 25、26 の厚さは、例えば $1 \mu\text{m}$ である。また、これらの電極 25、26 は、それぞれ開口 23a、23b を充填するように設けられている。これにより、開口 23a を介してアノード電極 25 が P⁺型不純物半導体

領域 11 と、開口 23 b を介してカソード電極 26 が N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 22 とそれぞれ直接に接続されている。アノード電極 25 及びカソード電極 26 としては、例えば A1 が用いられる。

【0030】

さらに、裏面入射型ホトダイオード 1 は、パッシベーション膜 31、支持膜 32、充填電極 33 a、33 b、UBM (Under Bump Metal) 34 a、34 b、及びバンプ 35 a、35 b を備えている。パッシベーション膜 31 は、N 型半導体基板 10 の上面 S1 上に於いて、絶縁膜 23、アノード電極 25 及びカソード電極 26 を覆うように設けられている。また、パッシベーション膜 31 のうちアノード電極 25 及びカソード電極 26 上に設けられた部分に、後述する充填電極 33 a、33 b が充填される貫通孔 31 a が形成されている。パッシベーション膜 31 は、例えば SiN からなり、N 型半導体基板 10 の上面 S1 を保護するものである。パッシベーション膜 31 は、例えばプラズマ CVD 法により形成することができる。また、パッシベーション膜 31 の厚さは、例えば 1 μm である。

【0031】

パッシベーション膜 31 上には、支持膜 32 が形成されている。支持膜 32 は、N 型半導体基板 10 を支持するものである。また、支持膜 32 のうちパッシベーション膜 31 の貫通孔 31 a に対応する部分に、貫通孔 31 a と共に充填電極 33 a、33 b が充填される貫通孔 32 a が形成されている。支持膜 32 の材料としては、例えば樹脂、或いはプラズマ CVD 等により形成可能な SiO₂ 等を用いることができる。また、支持膜 32 の厚さは、例えば 2 ~ 100 μm、好ましくは 50 μm である。

【0032】

充填電極 33 a、33 b は、貫通孔 31 a、32 a に充填されるとともに、一端がそれぞれアノード電極 25 及びカソード電極 26 に接することにより、P⁺ 型不純物半導体領域 11 及び N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 22 と電氣的に接続されている。また、充填電極 33 a、33 b の他端は、ともに支持膜 32 の表面に露出している。すなわち、充填電極 33 a、33 b は、パッシベーション膜 31 及び支持膜 32 を貫通して、それぞれアノード電極 25 及びカソード電極 26 から支持膜 32 表面まで延びている。また、充填電極 33 a、33 b は、略円柱状をしている。これらの充填電極 33 a、33 b は、電極 25、26 と後述するバンプ 35 a、35 b とを電氣的に接続するためのものである。充填電極 33 a、33 b は、例えば Cu からなる。また、貫通孔 31 a、32 a の直径は、例えば 10 ~ 200 μm、好ましくは 100 μm である。

【0033】

充填電極 33 a、33 b の支持膜 32 表面に露出する部分には、UBM 34 a、34 b が形成されている。UBM 34 a、34 b は、例えば Ni 及び Au の積層膜からなる。また、UBM 34 a、34 b の厚さは、例えば 0.1 ~ 5 μm である。

【0034】

UBM 34 a、34 b の充填電極 33 a、33 b と反対側の面上には、バンプ 35 a、35 b が形成されている。したがって、バンプ 35 a、35 b は、それぞれアノード電極 25 及びカソード電極 26 と電氣的に接続されている。バンプ 35 a、35 b は、UBM 34 a、34 b との接触面を除いては略球状をしている。バンプ 35 a、35 b としては、例えば半田、金、Ni-Au、Cu、又は金属フィラーを含む樹脂等を用いることができる。

【0035】

図 2 に、上記構成の裏面入射型ホトダイオード 1 の斜視図を示す。この図からわかるように、裏面入射型ホトダイオード 1 は、UBM 34 a、34 b 及びバンプ 35 a、35 b を除く全体形状が略直方体となるように、ダイシングされたものである。なお、図 2 においては、N 型半導体基板 10 の側面に露出する N⁺ 型高濃度不純物半導体層 21、N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 22 の図示を省略している。

【0036】

裏面入射型ホトダイオード 1 の動作について説明する。ここでは、裏面入射型ホトダイ

オード1に逆バイアス電圧が印加されており、N型半導体基板10には、薄板化された領域に空乏層が生じているものとする。窓板14及び被覆層13を順に透過して、凹部12からN型半導体基板10に入射した被検出光は、主に薄板化された領域で吸収される。すると、この領域でキャリア（正孔及び電子）が発生する。発生した正孔及び電子は、逆バイアス電界に従って、それぞれP⁺型不純物半導体領域11及びN⁺型高濃度不純物半導体領域22へと移動する。P⁺型不純物半導体領域11及びN⁺型高濃度不純物半導体領域22に達した正孔及び電子は、充填電極33a, 33b及びUBM34a, 34bを通してバンプ35a, 35bへと移動し、バンプ35a, 35bから検出信号として出力される。

【0037】

裏面入射型ホットダイオード1の効果について説明する。裏面入射型ホットダイオード1においては、被覆層13が設けられていることにより、裏面入射型ホットダイオード1の機械的強度が向上している。特に、凹部12上に被覆層13が設けられていることにより、アセンブリ時に裏面入射型ホットダイオード1に圧力や熱を加えても、N型半導体基板10の薄板化された領域の反り、撓み、破損等を防ぐことができる。また、機械的強度の向上により、ウエハレベルでのダイシングが可能となるため、チップサイズの裏面入射型ホットダイオード1を得ることができる。これにより、パッケージが十分に小さい裏面入射型ホットダイオード1が実現されている。また、セラミックパッケージ等が不要であるので、裏面入射型ホットダイオード1の製造コストを低減することができる。以上より、安価で信頼性が高く且つ小型な裏面入射型ホットダイオード1が実現されている。

【0038】

さらに、窓板14が被覆層13の表面S3上に設けられている。したがって、窓板14の表面が被検出光の入射面となり、入射面における被検出光の散乱が抑制される。また、窓板14を設ける際に、被覆層13の表面S3が窓板14に押し付けられることにより、窓板14と被覆層13との界面すなわち被覆層13の表面S3も十分に平坦化される。このため、被覆層13の表面S3における被検出光の散乱も抑制される。よって、高感度な裏面入射型ホットダイオード1が実現されている。また、窓板14は、裏面入射型ホットダイオード1の機械的強度を一層向上させている。なお、表面S3が平坦であるとは、表面S3が被検出光の波長レベルで滑らかであるという意味である。よって、被覆層13の表面S3形状は、平面に限定されず、曲面であってもよい。

【0039】

また、被覆層13の表面S3が実質的に平坦な形状をしていることにより、凹部12へと入射する被検出光の透過損失の増大を抑えることができる。仮に、被覆層13が樹脂層13aのみから構成されている場合、樹脂層13aの窪みに対応して樹脂層13aと窓板14との間に空気層が生じる。これにより樹脂層13aは、凹レンズとして作用し、被検出光を拡散させてしまう可能性がある。このような拡散が起こると、凹部12に入射する被検出光の光量が低下し、裏面入射型ホットダイオード1の感度低下につながるため望ましくない。

【0040】

これに対して、裏面入射型ホットダイオード1においては、樹脂層13a上に樹脂層13bを設けることにより、被覆層13の表面S3を実質的に平坦化している。これにより、裏面入射型ホットダイオード1においては、被覆層13と窓板14との間に空気層が生じないため、裏面入射型ホットダイオード1の高感度な光検出が保証されている。

【0041】

また、外縁部15上にも被覆層13が設けられていることにより、平コレットは外縁部15と直接接触しない。このため、平コレットとの接触により外縁部15に結晶欠陥が生じるのを抑制することができ、したがって、結晶欠陥に起因する暗電流やノイズの発生も抑制することができる。

【0042】

また、被覆層13として樹脂を用いているため、被覆層13を所望の形状に加工するこ

とが容易となる。

【0043】

被覆層13が樹脂層13a, 13bの2層から構成されていることは、裏面入射型ホトダイオード1の高感度な光検出を保証しつつ、製造工程の途中において平コレットを好適に用いる機会を提供している。すなわち、窓板14が設けられる前に平コレットを使用したい場合、樹脂層13a, 13bがともに設けられた後では、上述のように平コレットとの接触により樹脂層13bの表面S3が損傷を受けてしまう可能性があるし、一方で樹脂層13a, 13bが何れも設けられていない状態では、上述のように平コレットとの接触により外縁部15に結晶欠陥が生じる可能性がある。その結晶欠陥は、暗電流の増加や雑音の増加につながる。これに対して、被覆層13が樹脂層13a, 13bの2層から構成されていれば、樹脂層13a, 13bのうち樹脂層13aのみが設けられた状態で平コレットを使用することができる。そして、樹脂層13aは、凹部12上に設けられている部分が窪んでいるため、図3に示すように、凹部12上に設けられた樹脂層13aの表面は、平コレットFCと接触しない。これにより、樹脂層13a表面のうち被検出光が透過する部分は損傷を受けることがない。したがって、製造工程の途中で平コレットを用いても裏面入射型ホトダイオード1の高感度な光検出が保証される。

【0044】

さらに、樹脂層13bは、窓板14を被覆層13の表面S3上に設ける際の接着剤として機能することができる。

【0045】

支持膜32が設けられていることにより、裏面入射型ホトダイオード1の機械的強度が一層向上している。

【0046】

充填電極33a, 33bが設けられていることにより、検出信号を電極25, 26から外部に容易に取り出すことができる。なお、充填電極33a, 33bは、貫通孔31a, 32aの側壁に形成され、アノード電極25及びカソード電極26に電氣的に接続されるものであってもよい。

【0047】

N型半導体基板10の裏面S2側の表層全体にN⁺型高濃度不純物半導体層21が形成されている。裏面S2表層のうち凹部12の底面S4部分に設けられたN⁺型高濃度不純物半導体層21は、アキュムレーション層として機能する。これにより、N型半導体基板10で発生したキャリアをその電界分布により効果的に上面S1側のPN接合部へと導くことができる。このため、より高感度な裏面入射型ホトダイオード1が実現されている。このとき、N⁺型高濃度不純物半導体層21の不純物濃度は、 $10^{15}/\text{cm}^3$ 以上であることが好ましい。この場合、N⁺型高濃度不純物半導体層21は、アキュムレーション層として好適に機能することができる。

【0048】

また、N型半導体基板10の外縁部15の裏面S2側における表層に設けられたN⁺型高濃度不純物半導体層21は、外縁部15に結晶欠陥が生じている場合であっても、結晶欠陥に起因して発生する暗電流やノイズを抑制する。このため、裏面入射型ホトダイオード1によれば、高いS/N比で検出信号を得ることができる。このときも、N⁺型高濃度不純物半導体層21の不純物濃度は、 $10^{15}/\text{cm}^3$ 以上であることが好ましい。この場合、N⁺型高濃度不純物半導体層21は、結晶欠陥に起因して発生するノイズを十分に抑制することができる。

【0049】

図4～図10を参照しつつ、図1に示す裏面入射型ホトダイオード1の製造方法の一例を説明する。まず、上面S1及び裏面S2が(100)面であるN型シリコンウエハからなるN型半導体基板10を準備する。このN型半導体基板10に熱酸化を施すことにより、N型半導体基板10の上面S1にSiO₂からなる絶縁膜を形成する。また、絶縁膜の所定部分に開口を形成し、開口からN型半導体基板10にリンをドーピングすることによりN

⁺型高濃度不純物半導体領域 22 を形成する。その後、N 型半導体基板 10 を酸化させて、上面 S1 に絶縁膜を形成する。同様に、絶縁膜の所定部分に開口を形成し、開口から N 型半導体基板 10 にボロンをドーピングすることにより P⁺ 型不純物半導体領域 11 を形成する。その後、N 型半導体基板 10 を酸化させて、上面 S1 に絶縁膜 23 を形成する（図 4）。

【0050】

次に、N 型半導体基板 10 の裏面 S2 を研磨するとともに、N 型半導体基板 10 の裏面 S2 上に、LP-CVD により SiN84 を堆積させる（図 5（a））。また、凹部 12 を形成するために、裏面 S2 上の SiN84 に開口 85 を形成する（図 5（b））。そして、開口 85 から KOH 等によるエッチングを行うことにより凹部 12 を形成する（図 5（c））。

【0051】

次に、裏面 S2 上の SiN84 を除去した後、凹部 12 が形成された N 型半導体基板 10 の裏面 S2 に対しイオン注入等を用いて N 型不純物をドーピングすることにより、裏面 S2 側における表層全体に N⁺ 型高濃度不純物半導体層 21 を形成する（図 6（a））。その後、熱酸化を施すことにより裏面 S2 上に絶縁膜 24 を形成する（図 6（b））。上面 S1 の絶縁膜 23 に電極のためのコンタクトホールを形成し、上面 S1 にアルミニウムを堆積させてから所定のパターニングを施すことにより、アノード電極 25 及びカソード電極 26 を形成する（図 6（c））。

【0052】

次に、アノード電極 25 及びカソード電極 26 が形成された N 型半導体基板 10 の上面 S1 上に、SiN からなるパッシベーション膜 31 をプラズマ CVD 法により堆積させる。また、パッシベーション膜 31 におけるバンプ 35a, 35b に対応する部分に開口 31a を形成する（図 7（a））。さらに、上面 S1 上に樹脂や無機絶縁膜からなる厚い支持膜 32 を形成するとともに、パッシベーション膜 31 の開口 31a に対応する部分に開口 32a を形成する。このとき、支持膜 32 としては、樹脂であれば、例えばエポキシ系、アクリル系、又はポリイミド系のものを用いることができ、無機絶縁膜であれば、例えば CVD や SOG（Spin On Glass）等により形成可能な SiO₂ 等を用いることができる。また、支持膜 32 の開口 32a は、例えば樹脂として感光性のものを用いてフォトリソグラフィ法で形成するか、或いはエッチング等によるパターニングで形成することができる（図 7（b））。また、開口 31a 及び開口 32a を充填するように、上面 S1 上に Cu からなる導電性部材 33 を堆積させる。これは、例えば、開口 31a 及び開口 32a から露出するアノード電極 25 及びカソード電極 26 の表面に Cu シード層等をスパッタ等により堆積させた後、その Cu シード層上にメッキにより Cu 等を堆積させることにより行うことができる（図 7（c））。

【0053】

次に、導電性部材 33 の表面を研磨することにより、支持膜 32 上に堆積された導電性部材 33 を除去する。これにより、充填電極 33a, 33b が形成される（図 8（a））。また、裏面 S2 上に樹脂層 13a をスピンコート又は印刷等により塗布するとともに、塗布した樹脂層 13a を硬化させる。このとき、樹脂層 13a のうち凹部 12 上に設けられている部分が窪むようにする（図 8（b））。さらに、樹脂層 13a 上に樹脂層 13b を塗布する（図 8（c））。

【0054】

次に、樹脂層 13b の表面 S3 に窓板 14 を貼り付ける。このとき、樹脂層 13b を硬化させる前に窓板 14 の貼り付けを行うことにより、樹脂層 13b を接着剤として機能させる。また、貼り付けの際に窓板 14 を樹脂層 13b に対して軽く押し付けることにより、樹脂層 13b の表面 S3 を十分に平坦化する（図 9（a））。また、上面 S1 上の充填電極 33a, 33b 上に、それぞれ Ni と Au 等の積層膜からなる UBM34a, 34b を無電解メッキにより形成する。さらに、UBM34a, 34b 上に、半田等からなるバンプ 35a, 35b を印刷又はボール搭載法等により形成する（図 9（b））。

【0055】

最後に、個片化された裏面入射型ホトダイオード1を得るために、ダイシングを行う。ダイシングは、図10(a)に一点鎖線L1で示すように、N型半導体基板10の裏面S2における外縁部15の中央を通るように切断する。以上により、裏面入射型ホトダイオード1を得る(図10(b))。

【0056】

図11は、図1の裏面入射型ホトダイオード1の変形例を示す斜視図である。裏面入射型ホトダイオード1aは、窓板14に切り欠き部14aが形成されている点で、図1の裏面入射型ホトダイオード1と相違する。裏面入射型ホトダイオード1aのその他の構成については、図1の裏面入射型ホトダイオード1と同様である。図11からわかるように、窓板14は厚さ方向に垂直な面での断面が四角形であり、その四角形の4角にそれぞれ切り欠き部14aが形成されている。切り欠き部14aの形状は、上記断面において、四角形の角を中心とする中心角90°の扇形である。また、切り欠き部14aからは、被覆層13(樹脂層13b)の表面S3が露出している。なお、切り欠き部14aは、上記断面における形状が扇形のものに限らず、角状のものであってもよい。

【0057】

このように、裏面入射型ホトダイオード1aにおいては、窓板14の角、すなわちダイシング時に2本のダイシングラインが交わる位置に切り欠き部14aが形成されているため、ダイシング時におけるチップング(クラック)の発生が抑制されている。

【0058】

図12を用いて、窓板14とダイシングラインとの位置関係について説明する。図12は、図1の裏面入射型ホトダイオード1について、ダイシング前のウエハ(例えば、図10(a)に示す状態のウエハ)を窓板14側から見たときの様子を示す平面図である。この平面図においては、凹部12が形成されている部分を破線L2で示している。凹部12は、ダイシング前のウエハにおいて格子状に等間隔で配列されていることがわかる。また、ダイシング時のダイシングラインを一点鎖線L3で示している。ダイシングラインは図中の上下方向及び左右方向にそれぞれ設定されており、互いに隣り合う凹部12間の真中をダイシングラインが通っている。ダイシングラインで囲まれている各々の領域が、ダイシング後の裏面入射型ホトダイオード1に対応する。図12からわかるように、ダイシング後の裏面入射型ホトダイオード1における窓板14の角は、2本のダイシングラインが交わる位置Pに当たる。N型半導体基板10における位置Pに対応する位置、すなわち裏面S2の4角は、ダイシング時に応力を集中的に受けるため、チップングが生じる可能性がある。

【0059】

これに対して、図11の裏面入射型ホトダイオード1aにおいては、窓板14の角に切り欠き部14aを形成することにより、ダイシングラインが交わる位置Pにおける窓板14のダイシングを避けている。これにより、N型半導体基板10の裏面S2の4角にかかる応力が緩和されるため、裏面入射型ホトダイオード1aにおいては、ダイシング時のチップングの発生が抑制されている。

【0060】

図13は、図11の裏面入射型ホトダイオード1aについて、ダイシング前のウエハを窓板14側から見たときの様子を示す平面図である。この平面図に示すように、ダイシングラインが交わる位置Pには、円柱状の孔部14bが形成されている。この孔部14bは、窓板14に形成されているもので、窓板14を貫通している。切り欠き部14aは、この孔部14bに由来している。すなわち、孔部14bは、ダイシングにより4等分されて、裏面入射型ホトダイオード1aにおける切り欠き部14aとなる。なお、裏面入射型ホトダイオード1aの製造工程においては、所定位置に予め孔部14bが形成された窓板14を、ダイシングラインが交わる位置Pと孔部14bとが一致するように被覆層13の表面S3に貼り付ければよい。なお、孔部14bは円柱状のものに限らず、角柱状のもの等であってもよい。

【0061】

図14は、本発明による裏面入射型光検出素子の第2実施形態を示す断面図である。裏面入射型ホットダイオード2は、N型半導体基板10、P⁺型不純物半導体領域11、凹部12、被覆層16、及び窓板14を備えている。N型半導体基板10の上面S1側における表層の一部には、P⁺型不純物半導体領域11が形成されている。N型半導体基板10の裏面S2におけるP⁺型不純物半導体領域11に対向する領域には、凹部12が形成されている。

【0062】

N型半導体基板10の裏面S2上には、被覆層16が設けられている。被覆層16は、被検出光に対して透明な樹脂からなり、N型半導体基板10の裏面S2上に設けられている。また、被覆層16の表面S3の形状は、実質的に平坦である。被覆層16は、2つの樹脂層13a、13bから構成されている図1の被覆層13とは異なり、1層から構成されている。外縁部15を基準とした被覆層16の厚さt3は、例えば1~100 μ m、好ましくは20 μ mである。また、被覆層16の表面S3上には、窓板14が設けられている。

【0063】

また、裏面入射型ホットダイオード2は、N⁺型高濃度不純物半導体層21、N⁺型高濃度不純物半導体領域22、絶縁膜23、24、アノード電極25、及びカソード電極26を備えている。N⁺型高濃度不純物半導体層21は、N型半導体基板10の裏面S2側の表層全体に形成されている。N⁺型高濃度不純物半導体領域22は、N型半導体基板10の上面S1側における表層に、P⁺型不純物半導体領域11と所定の距離を隔てて形成されている。絶縁膜23及び絶縁膜24は、それぞれN型半導体基板10の上面S1及び裏面S2上に形成されている。絶縁膜23には、開口23a、23bが形成されている。絶縁膜23上の開口23a、23bを含む領域には、それぞれアノード電極25及びカソード電極26が形成されている。

【0064】

さらに、裏面入射型ホットダイオード2は、パッシベーション膜31、支持膜32、充填電極33a、33b、UBM34a、34b、及びバンプ35a、35bを備えている。パッシベーション膜31は、N型半導体基板10の上面S1上において、絶縁膜23、アノード電極25及びカソード電極26を覆うように設けられている。パッシベーション膜31上には、支持膜32が形成されている。また、充填電極33a、33bは、パッシベーション膜31及び支持膜32を貫通して、それぞれアノード電極25及びカソード電極26から支持膜32表面まで延びている。充填電極33a、33bの支持膜32表面に露出する部分には、UBM34a、34bが形成されている。UBM34a、34bの充填電極33a、33bと反対側の面上には、バンプ35a、35bが形成されている。

【0065】

裏面入射型ホットダイオード2の効果について説明する。裏面入射型ホットダイオード2においては、被覆層16が設けられていることにより、裏面入射型ホットダイオード2の機械的強度が向上している。また、機械的強度の向上により、ウエハレベルでのダイシングが可能となるため、チップサイズの裏面入射型ホットダイオード2を得ることができる。これにより、パッケージが十分に小さい裏面入射型ホットダイオード2が実現されている。

【0066】

さらに、窓板14が被覆層16の表面S3上に設けられている。したがって、窓板14の表面が被検出光の入射面となり、入射面における被検出光の散乱が抑制される。また、窓板14と被覆層16との界面すなわち被覆層16の表面S3も十分に平坦化されるため、被覆層16の表面S3における被検出光の散乱も抑制される。よって、高感度な裏面入射型ホットダイオード2が実現されている。

【0067】

また、裏面入射型ホットダイオード2においては、被覆層16が1層から構成されている。このため、被覆層16は、2層から構成されている図1の被覆層13に比して製造工程

が簡略化され、ひいては裏面入射型ホトダイオード2全体の製造工程が簡略化される。

【0068】

図15は、本発明による裏面入射型光検出素子の第3実施形態を示す断面図である。裏面入射型ホトダイオード3は、N型半導体基板20、P⁺型不純物半導体領域11、凹部12、被覆層13、及び窓板14を備えている。

【0069】

N型半導体基板20の上面S1側における表層の一部には、P⁺型不純物半導体領域11が形成されている。N型半導体基板20の裏面S2におけるP⁺型不純物半導体領域11に対向する領域には、凹部12が形成されている。N型半導体基板20の裏面S2上には、樹脂層13a、13bから構成される被覆層13が設けられている。被覆層13の表面S3の形状は、実質的に平坦である。被覆層13の表面S3上には、窓板14が設けられている。

【0070】

また、裏面入射型ホトダイオード3は、N⁺型高濃度不純物半導体領域28、絶縁膜23、24、アノード電極25、及びカソード電極26を備えている。N⁺型高濃度不純物半導体領域28は、N型半導体基板20の側面S5全体に露出するようにして形成されている。また、N⁺型高濃度不純物半導体領域28は、N型半導体基板20の裏面S2全体にも達している。したがって、N型半導体基板20のうち、P⁺型不純物半導体領域11及びN⁺型高濃度不純物半導体領域28の何れも形成されていない部分20aが、N型半導体基板20の側面S5及び裏面S2側からN⁺型高濃度不純物半導体領域28によって完全に囲まれている。

【0071】

図16(a)～図16(c)を参照しつつ、N⁺型高濃度不純物半導体領域28を形成する方法の一例を示す。まず、N型半導体基板20を準備する。N型半導体基板20においては、N⁺型高濃度不純物層41が、上面S1側の一部分を残して裏面S2から拡がっている。残された上面S1側の一部分が、N⁺型高濃度不純物層41よりも不純物濃度が低いN型不純物層42である(図16(a))。次に、上面S1側からN型不純物を高濃度にドーピングさせることにより、N⁺型高濃度不純物半導体領域43を形成する(図16(b))。そして、N型不純物を熱処理により更に深く拡散させることにより、このN⁺型高濃度不純物半導体領域43がN⁺型高濃度不純物層41まで達するようにする(図16(c))。以上より、N⁺型高濃度不純物層41とN⁺型高濃度不純物半導体領域43とからなるN⁺型高濃度不純物半導体領域28が形成される。なお、図16(c)には、P⁺型不純物半導体領域11及び凹部12が形成される領域をそれぞれ破線L4、L5によって示している。この方法によれば、N型半導体基板20の裏面S2側から不純物をドーピングする工程を省略することができるので、N⁺型高濃度不純物半導体領域28の製造工程が簡略化され、ひいては裏面入射型ホトダイオード3全体の製造工程が簡略化される。

【0072】

図15に戻って、N型半導体基板20の上面S1及び裏面S2には、それぞれ絶縁膜23及び絶縁膜24が形成されている。また、絶縁膜23には、開口23a、23bが形成されており、一方の開口23aはP⁺型不純物半導体領域11の部分に、他方の開口23bはN⁺型高濃度不純物半導体領域28の部分に設けられている。

【0073】

絶縁膜23上の開口23a、23bを含む領域には、それぞれアノード電極25及びカソード電極26が形成されている。これらの電極25、26は、それぞれ開口23a、23bを充填するように設けられている。これにより、開口23aを介してアノード電極25がP⁺型不純物半導体領域11と、開口23bを介してカソード電極26がN⁺型高濃度不純物半導体領域28とそれぞれ直接に接続されている。

【0074】

さらに、裏面入射型ホトダイオード3は、パッシベーション膜31、支持膜32、充填電極33a、33b、UBM34a、34b、及びバンプ35a、35bを備えている。

パッシベーション膜 31 は、N 型半導体基板 20 の上面 S1 上において、絶縁膜 23、アノード電極 25 及びカソード電極 26 を覆うように設けられている。パッシベーション膜 31 上には、支持膜 32 が形成されている。また、充填電極 33a, 33b は、パッシベーション膜 31 及び支持膜 32 を貫通して、それぞれアノード電極 25 及びカソード電極 26 から支持膜 32 表面まで延びている。充填電極 33a, 33b の支持膜 32 表面に露出する部分には、UBM 34a, 34b が形成されている。UBM 34a, 34b の充填電極 33a, 33b と反対側の面上には、バンプ 35a, 35b が形成されている。

【0075】

裏面入射型ホトダイオード 3 の効果について説明する。裏面入射型ホトダイオード 3 においては、被覆層 13 が設けられていることにより、裏面入射型ホトダイオード 3 の機械的強度が向上している。また、機械的強度の向上により、ウエハレベルでのダイシングが可能となるため、チップサイズの裏面入射型ホトダイオード 3 を得ることができる。これにより、パッケージが十分に小さい裏面入射型ホトダイオード 3 が実現されている。

【0076】

さらに、窓板 14 が被覆層 13 の表面 S3 上に設けられている。したがって、窓板 14 の表面が被検出光の入射面となり、入射面における被検出光の散乱が抑制される。また、窓板 14 と被覆層 13 との界面すなわち被覆層 13 の表面 S3 も十分に平坦化されるため、被覆層 13 の表面 S3 における被検出光の散乱も抑制される。よって、高感度な裏面入射型ホトダイオード 3 が実現されている。

【0077】

また、裏面入射型ホトダイオード 3 においては、N⁺型高濃度不純物半導体領域 28 が N 型半導体基板 20 の側面 S5 全体に露出するようにして形成されている。これにより、ダイシングの際のダメージ等により、N 型半導体基板 20 の側面 S5 付近で発生した不要キャリアによる暗電流やノイズを N⁺型高濃度不純物半導体領域 28 により抑制することができる。側面 S5 は、ダイシングラインに当たるため、ダイシング時に結晶欠陥が生じている可能性があるが、かかる結晶欠陥に起因して発生する暗電流等のノイズも N⁺型高濃度不純物半導体領域 28 によって抑制される。このため、裏面入射型ホトダイオード 3 によれば、より高い SN 比で検出信号を得ることができる。

【0078】

また、N 型半導体基板 20 の一部分 20a が、N 型半導体基板 20 の側面 S5 及び裏面 S2 側から N⁺型高濃度不純物半導体領域 28 によって完全に囲まれている。これにより、囲まれた部分 20a を I 層とする PIN 構造が実現されている。このため、裏面入射型ホトダイオード 3 は、このような PIN 構造により、空乏層を厚くして光の吸収する長さを増やすことによる感度増加と、空乏層が厚いことによる電気二重層の間隔が大きくなることにより容量が低下して高速応答が可能となる。

【0079】

図 17 は、本発明による裏面入射型光検出素子の第 4 実施形態を示す断面図である。裏面入射型ホトダイオード 4 は、N 型半導体基板 20、P⁺型不純物半導体領域 11、凹部 12、被覆層 16、及び窓板 14 を備えている。N 型半導体基板 20 の上面 S1 側における表層の一部には、P⁺型不純物半導体領域 11 が形成されている。N 型半導体基板 20 の裏面 S2 における P⁺型不純物半導体領域 11 に対向する領域には、凹部 12 が形成されている。

【0080】

N 型半導体基板 20 の裏面 S2 上には、被覆層 16 が設けられている。被覆層 16 は、被検出光に対して透明な樹脂からなり、N 型半導体基板 20 の裏面 S2 上に設けられている。また、被覆層 16 の表面 S3 の形状は、実質的に平坦である。被覆層 16 の表面 S3 上には、窓板 14 が設けられている。

【0081】

また、裏面入射型ホトダイオード 4 は、N⁺型高濃度不純物半導体領域 28、絶縁膜 23, 24、アノード電極 25、及びカソード電極 26 を備えている。N⁺型高濃度不純物

半導体領域 28 は、N 型半導体基板 20 の側面 S5 全体に露出するようにして形成されている。また、N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 28 は、N 型半導体基板 20 の裏面 S2 全体にも達している。したがって、N 型半導体基板 20 のうち、P⁺ 型不純物半導体領域 11 及び N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 28 の何れも形成されていない部分 20a が、N 型半導体基板 20 の側面 S5 及び裏面 S2 側から N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 28 によって完全に囲まれている。

【0082】

N 型半導体基板 20 の上面 S1 及び裏面 S2 には、それぞれ絶縁膜 23 及び絶縁膜 24 が形成されている。また、絶縁膜 23 には、開口 23a, 23b が形成されており、一方の開口 23a は P⁺ 型不純物半導体領域 11 の部分に、他方の開口 23b は N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 28 の部分に設けられている。

【0083】

絶縁膜 23 上の開口 23a, 23b を含む領域には、それぞれアノード電極 25 及びカソード電極 26 が形成されている。これらの電極 25, 26 は、それぞれ開口 23a, 23b を充填するように設けられている。これにより、開口 23a を介してアノード電極 25 が P⁺ 型不純物半導体領域 11 と、開口 23b を介してカソード電極 26 が N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 28 とそれぞれ直接に接続されている。

【0084】

さらに、裏面入射型ホトダイオード 4 は、パッシベーション膜 31、支持膜 32、充填電極 33a, 33b、UBM 34a, 34b、及びバンプ 35a, 35b を備えている。パッシベーション膜 31 は、N 型半導体基板 20 の上面 S1 上において、絶縁膜 23、アノード電極 25 及びカソード電極 26 を覆うように設けられている。パッシベーション膜 31 上には、支持膜 32 が形成されている。また、充填電極 33a, 33b は、パッシベーション膜 31 及び支持膜 32 を貫通して、それぞれアノード電極 25 及びカソード電極 26 から支持膜 32 表面まで延びている。充填電極 33a, 33b の支持膜 32 表面に露出する部分には、UBM 34a, 34b が形成されている。UBM 34a, 34b の充填電極 33a, 33b と反対側の面上には、バンプ 35a, 35b が形成されている。

【0085】

裏面入射型ホトダイオード 4 の効果について説明する。裏面入射型ホトダイオード 4 においては、被覆層 16 が設けられていることにより、裏面入射型ホトダイオード 4 の機械的強度が向上している。また、機械的強度の向上により、ウエハレベルでのダイシングが可能となるため、チップサイズの裏面入射型ホトダイオード 4 を得ることができる。これにより、パッケージが十分に小さい裏面入射型ホトダイオード 4 が実現されている。

【0086】

さらに、窓板 14 が被覆層 16 の表面 S3 上に設けられている。したがって、窓板 14 の表面が被検出光の入射面となり、入射面における被検出光の散乱が抑制される。また、窓板 14 と被覆層 16 との界面すなわち被覆層 16 の表面 S3 も十分に平坦化されるため、被覆層 16 の表面 S3 における被検出光の散乱も抑制される。よって、高感度な裏面入射型ホトダイオード 4 が実現されている。

【0087】

また、裏面入射型ホトダイオード 4 においては、被覆層 16 が 1 層から構成されている。このため、被覆層 16 は、製造工程が簡略化され、ひいては裏面入射型ホトダイオード 4 全体の製造工程が簡略化される。

【0088】

また、裏面入射型ホトダイオード 4 においては、N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 28 が N 型半導体基板 20 の側面 S5 全体に露出するようにして形成されている。これにより、ダイシングの際のダメージ等により、N 型半導体基板 20 の側面 S5 付近で発生した不要キャリアによる暗電流やノイズを N⁺ 型高濃度不純物半導体領域 28 により抑制することができる。このため、裏面入射型ホトダイオード 4 によれば、より高い SN 比で検出信号を得ることができる。さらに、N 型半導体基板 20 の一部分 20a が、N 型半導体基板 2

0の側面S5及び裏面S2側からN⁺型高濃度不純物半導体領域28によって完全に囲まれている。このため、裏面入射型ホトダイオード4は、このようなPIN構造により、空乏層を厚くして光の吸収する長さを増やすことによる感度増加と、空乏層が厚いことによる電気二重層の間隔が離れることにより容量が低下して高速応答が可能となる。

【0089】

図18は、本発明による裏面入射型光検出素子の第5実施形態を示す平面図である。裏面入射型ホトダイオードアレイ5は、縦横にそれぞれ8列、全部で64個の裏面入射型ホトダイオードが格子状に配列されて成っている。これらのホトダイオードの配列ピッチは、例えば1mmとされる。図18は、裏面入射型ホトダイオードアレイ5を裏面側から見たときの様子を示している。各ホトダイオードにおいては、図1の裏面入射型ホトダイオード1と同様に、裏面が被覆層及び窓板で覆われている。なお、図18には、凹部が形成されている部分を破線L6で示している。

【0090】

図19は、図18に示す裏面入射型ホトダイオードアレイ5のXIX-XIX線に沿った断面図である。この断面図においては、図18に示す64個のホトダイオードのうち2個のホトダイオードP1、P2が示されている。図19に示すように、裏面入射型ホトダイオードアレイ5は、N型半導体基板50、P⁺型不純物半導体領域51、凹部52、被覆層53、及び窓板54を備えている。

【0091】

N型半導体基板50の上面S1側における表層には、P⁺型不純物半導体領域51が複数形成されている。これらのP⁺型不純物半導体領域51は、ホトダイオードP1、P2に対してそれぞれ設けられている。各P⁺型不純物半導体領域51の面積は、例えば0.75×0.75mm²である。N型半導体基板50の裏面S2におけるP⁺型不純物半導体領域51に臨む領域には、凹部52が形成されている。ここでは、P⁺型不純物半導体領域51が複数設けられていることに伴い、凹部52も複数形成されている。P⁺型不純物半導体領域51及び凹部52は、各ホトダイオードP1、P2に一組ずつ設けられている。また、N型半導体基板50の裏面S2上には、被覆層53が設けられている。

【0092】

被覆層53は、裏面S2上に設けられた樹脂層53aと、樹脂層53a上に設けられた樹脂層53bとから構成されている。樹脂層53a、53bには、被検出光に対して透明な樹脂が用いられる。樹脂層53aは、凹部52上に設けられている部分が、凹部52の外縁部55上に設けられている部分に対して窪んでいる。樹脂層53bは、樹脂層53aと隙間なく密着しており、それゆえ樹脂層53aの窪みに一致する突出部を樹脂層53a側に複数有する形状をしている。一方で、樹脂層53bの表面S3の形状は、実質的に平坦である。被覆層53の表面S3上には、窓板54が設けられている。

【0093】

また、裏面入射型ホトダイオードアレイ5は、N⁺型高濃度不純物半導体層61、N⁺型高濃度不純物半導体領域62、絶縁膜63、64、アノード電極65、及びカソード電極66を備えている。N⁺型高濃度不純物半導体層61は、N型半導体基板50の裏面S2側の表層全体に形成されている。N⁺型高濃度不純物半導体領域62は、N型半導体基板50の上面S1側における表層に形成されている。このN⁺型高濃度不純物半導体領域62は、各ホトダイオードを構成するP⁺型不純物半導体領域51を取り囲むように設けることが望ましい。

【0094】

N型半導体基板50の上面S1及び裏面S2上には、それぞれ絶縁膜63及び絶縁膜64が形成されている。絶縁膜63には、開口63a、63bが形成されており、一方の開口63aはP⁺型不純物半導体領域51の部分に、他方の開口63bはN⁺型高濃度不純物半導体領域62の部分に設けられている。

【0095】

絶縁膜63上の開口63a、63bを含む領域には、それぞれアノード電極65及びカ

ソード電極66が形成されている。アノード電極65及びカソード電極66は、各ホットダイオードP1, P2に1組ずつ設けられている。また、これらの電極65, 66は、それぞれ開口63a, 63bを充填するように設けられている。これにより、開口63aを介してアノード電極65がP⁺型不純物半導体領域51と、開口63bを介してカソード電極66がN⁺型高濃度不純物半導体領域62とそれぞれ直接に接続されている。

【0096】

さらに、裏面入射型ホットダイオードアレイ5は、パッシベーション膜71、支持膜72、充填電極73a, 73b、UBM74a, 74b、及びバンプ75a, 75bを備えている。パッシベーション膜71は、N型半導体基板50の上面S1上において、絶縁膜63、アノード電極65及びカソード電極66を覆うように設けられている。パッシベーション膜71上には、支持膜72が形成されている。また、充填電極73a, 73bは、パッシベーション膜71及び支持膜72を貫通して、それぞれアノード電極65及びカソード電極66から支持膜72表面まで延びている。充填電極73a, 73bの支持膜72表面に露出する部分には、UBM74a, 74bが形成されている。UBM74a, 74bの充填電極73a, 73bと反対側の面上には、バンプ75a, 75bが形成されている。

【0097】

裏面入射型ホットダイオードアレイ5の効果について説明する。裏面入射型ホットダイオードアレイ5においては、被覆層16が設けられていることにより、裏面入射型ホットダイオードアレイ5の機械的強度が向上している。また、機械的強度の向上により、ウエハレベルでのダイシングが可能となるため、周辺に余分なエリアのないアレイサイズびっりの裏面入射型ホットダイオードアレイ5を得ることができる。これにより、パッケージが十分に小さい裏面入射型ホットダイオードアレイ5が実現されている。

【0098】

さらに、窓板54が被覆層53の表面S3上に設けられている。したがって、窓板54の表面が被検出光の入射面となり、入射面における被検出光の散乱が抑制される。また、また、窓板54と被覆層53との界面すなわち被覆層53の表面S3も十分に平坦化されるため、被覆層53の表面S3における被検出光の散乱も抑制される。よって、高感度な裏面入射型ホットダイオードアレイ5が実現されている。

【0099】

さらに、N型半導体基板50の上面S1側の表層における複数の領域にP⁺型不純物半導体領域51が形成されるとともに、裏面S2におけるそれぞれのP⁺型不純物半導体領域51に対向する領域に凹部52が形成されることにより、複数のホットダイオードが構成されている。このため、裏面入射型ホットダイオードアレイ5は、各ホットダイオードが1画素に対応するイメージセンサ等に好適に用いることができる。

【0100】

本発明による裏面入射型光検出素子は、上記実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。例えば、図1の裏面入射型ホットダイオード1において、N型半導体基板10の代わりにP型半導体基板を用いてもよい。この場合には、不純物半導体領域11はN型高濃度不純物半導体層21及び高濃度不純物半導体領域22はP型の導電型をもつようにする。

【0101】

また、図7(c)において、Cuからなる導電性部材33を堆積させる例を示したが、Cuの代わりにNiを用い、開口31a及び開口32aから露出するアノード電極25及びカソード電極26の表面に直接、Niの無電解メッキを施してもよい。この場合、図8(a)において説明した導電性部材33表面を研磨する工程を省くことができる。

【0102】

また、図9(b)においては、充填電極33a, 33b上にUBM34a, 34b及びバンプ35a, 35bを形成する例を示したが、充填電極33a, 33b自体をバンプとする方法もある。すなわち、開口32aに充填電極33a, 33bが充填された状態の支

持膜 32 (図 9 (a) 参照) 表面を、 O_2 等を用いてドライエッチングする。これにより、充填電極 33a, 33b の一部が支持膜 32 表面から突出するので、この突出した部分をバンプとして用いればよい。この場合、UBM 34a, 34b も形成する必要がない。或いは、充填電極 33a, 33b を形成する導電性部材として、導電性樹脂を用いてもよい。これによれば、印刷等により貫通孔への電極充填作業を短時間で完了させることが可能となる。

【0103】

また、図 11 においては、窓板 14 の 4 角にそれぞれ切り欠き部 14a が形成されている構成を示したが、窓板 14 の 4 角のうち少なくとも 1 つの角に切り欠き部 14a が形成されていればよい。この場合も、切り欠き部 14a が全く設けられていない場合に比してチップングの発生確率を低減することができる。

【0104】

また、図 16 (a) においては、 N^+ 型高濃度不純物層と N^+ 型高濃度不純物層よりも不純物濃度が低い N 型不純物層とが貼り合わされた貼り合わせウエハを N 型半導体基板 20 として用いてもよい。この場合、 N 型半導体基板 20 の上面 S1 側に N 型不純物層が、裏面 S2 側に N^+ 型高濃度不純物層が設けられる。

【図面の簡単な説明】

【0105】

【図 1】本発明による裏面入射型光検出素子の第 1 実施形態を示す断面図である。

【図 2】図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 を示す斜視図である。

【図 3】図 1 に示す裏面入射型ホトダイオード 1 の効果を説明するための図である。

【図 4】図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 を製造する方法を示す工程図である。

【図 5】(a) ~ (c) は、図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 を製造する方法を示す工程図である。

【図 6】(a) ~ (c) は、図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 を製造する方法を示す工程図である。

【図 7】(a) ~ (c) は、図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 を製造する方法を示す工程図である。

【図 8】(a) ~ (c) は、図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 を製造する方法を示す工程図である。

【図 9】(a) 及び (b) は、図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 を製造する方法を示す工程図である。

【図 10】(a) 及び (b) は、図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 を製造する方法を示す工程図である。

【図 11】図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 の変形例を示す斜視図である。

【図 12】図 1 の裏面入射型ホトダイオード 1 について、ダイシング前のウエハを窓板 14 側から見たときの様子を示す平面図である。

【図 13】図 11 の裏面入射型ホトダイオード 1a について、ダイシング前のウエハを窓板 14 側から見たときの様子を示す平面図である。

【図 14】本発明による裏面入射型光検出素子の第 2 実施形態を示す断面図である。

【図 15】本発明による裏面入射型光検出素子の第 3 実施形態を示す断面図である。

【図 16】(a) ~ (c) は、図 15 における N^+ 型高濃度不純物半導体領域 28 を形成する方法の一例を説明するための図である。

【図 17】本発明による裏面入射型光検出素子の第 4 実施形態を示す断面図である。

【図 18】本発明による裏面入射型光検出素子の第 5 実施形態を示す平面図である。

【図 19】図 18 に示す裏面入射型ホトダイオードアレイ 5 の XIX-XIX 線に沿った断面図である。

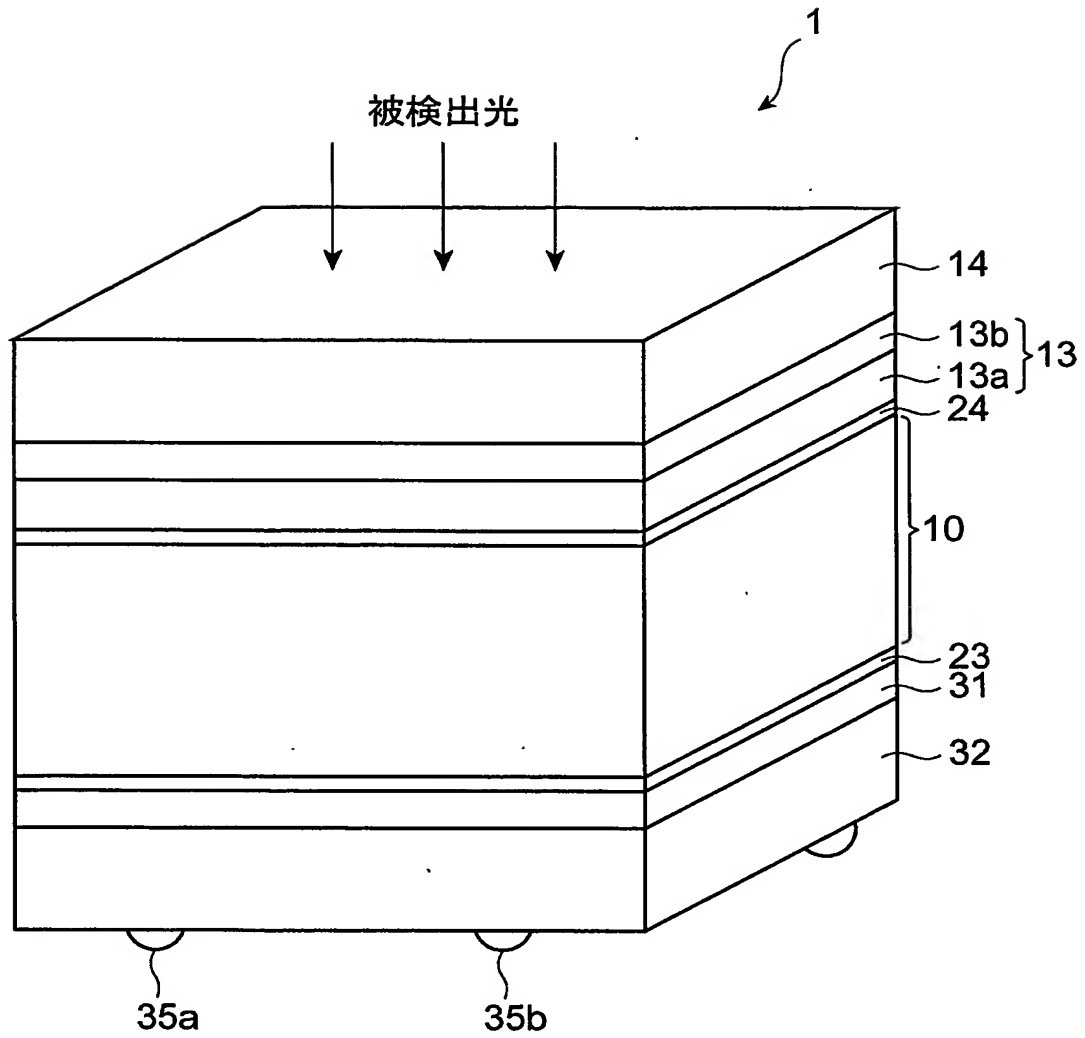
【図 20】従来の裏面入射型ホトダイオードを示す断面図である。

【符号の説明】

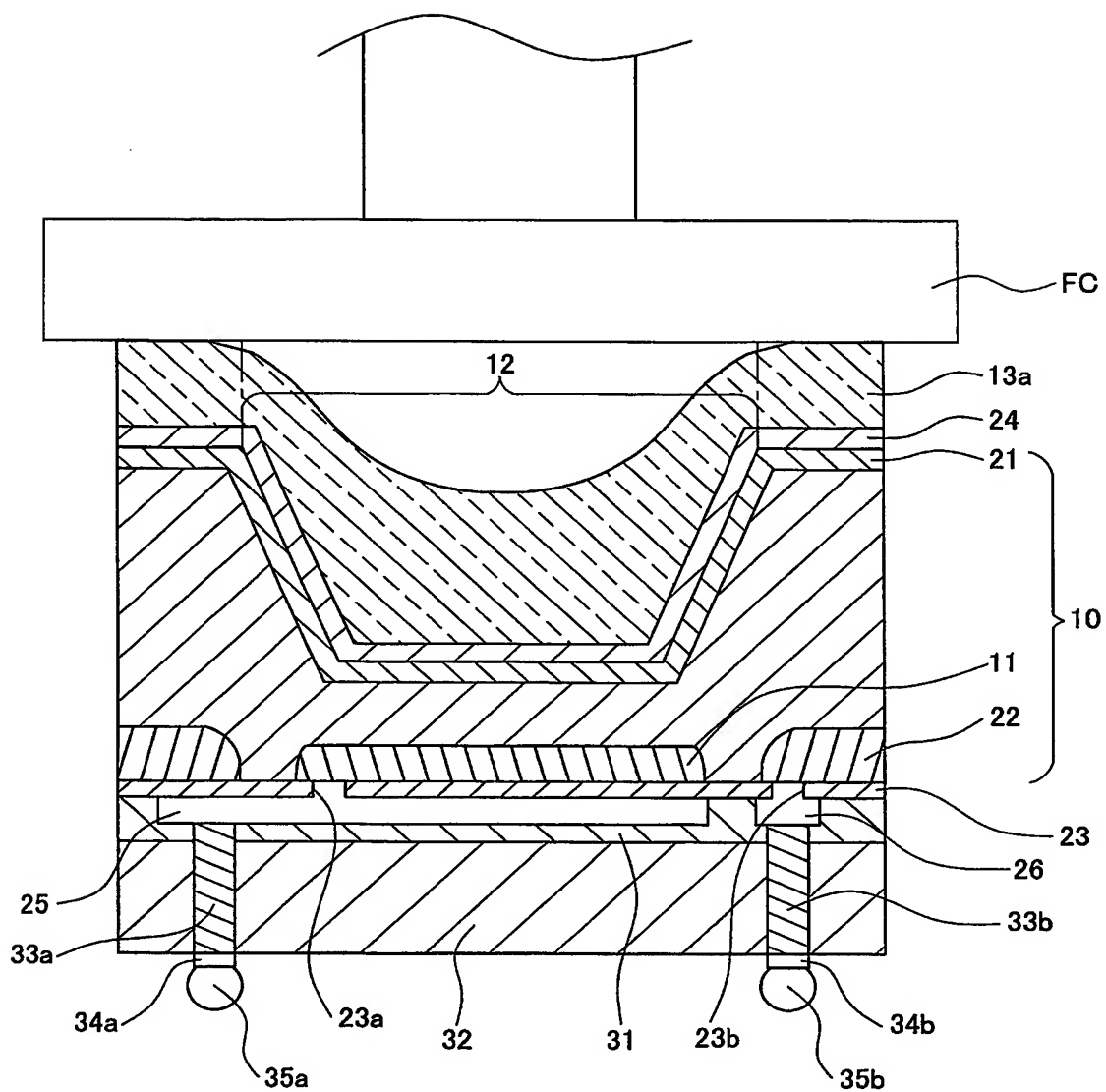
【0106】

1, 1a, 2, 3, 4…裏面入射型ホトダイオード、5…裏面入射型ホトダイオードアレイ、10, 20, 50…N型半導体基板、11, 51…P⁺型不純物半導体領域、12, 52…凹部、13, 16, 53…被覆層、13a, 13b, 53a, 53b…樹脂層、14, 54…窓板、14a…切り欠き部、14b…孔部、15, 55…外縁部、21, 61…N⁺型高濃度不純物半導体層、22, 28, 62…N⁺型高濃度不純物半導体領域、23, 24, 63, 64…絶縁膜、25, 65…アノード電極、26, 66…カソード電極、31, 71…パッシベーション膜、32, 72…支持膜、33a, 33b, 73a, 73b…充填電極、34a, 34b, 74a, 74b…UBM、35a, 35b, 75a, 75b…バンプ、S1…上面、S2…裏面、S3…被覆層13の表面、S4…凹部底面、S5…N型半導体基板20の側面。

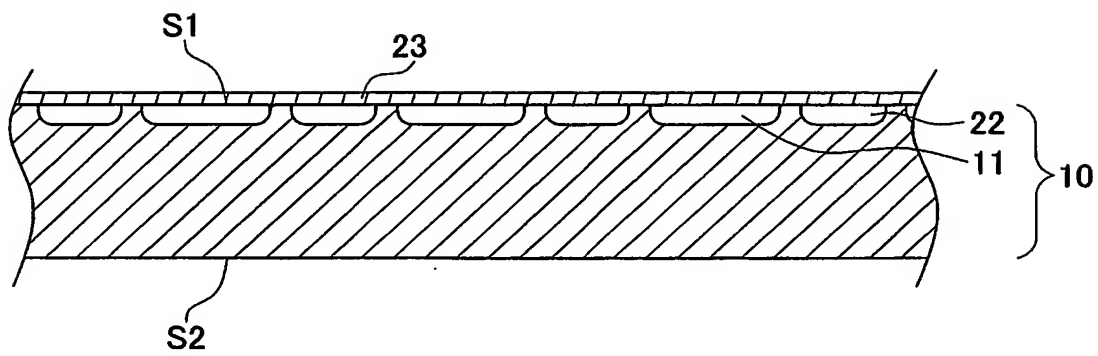
【図 2】



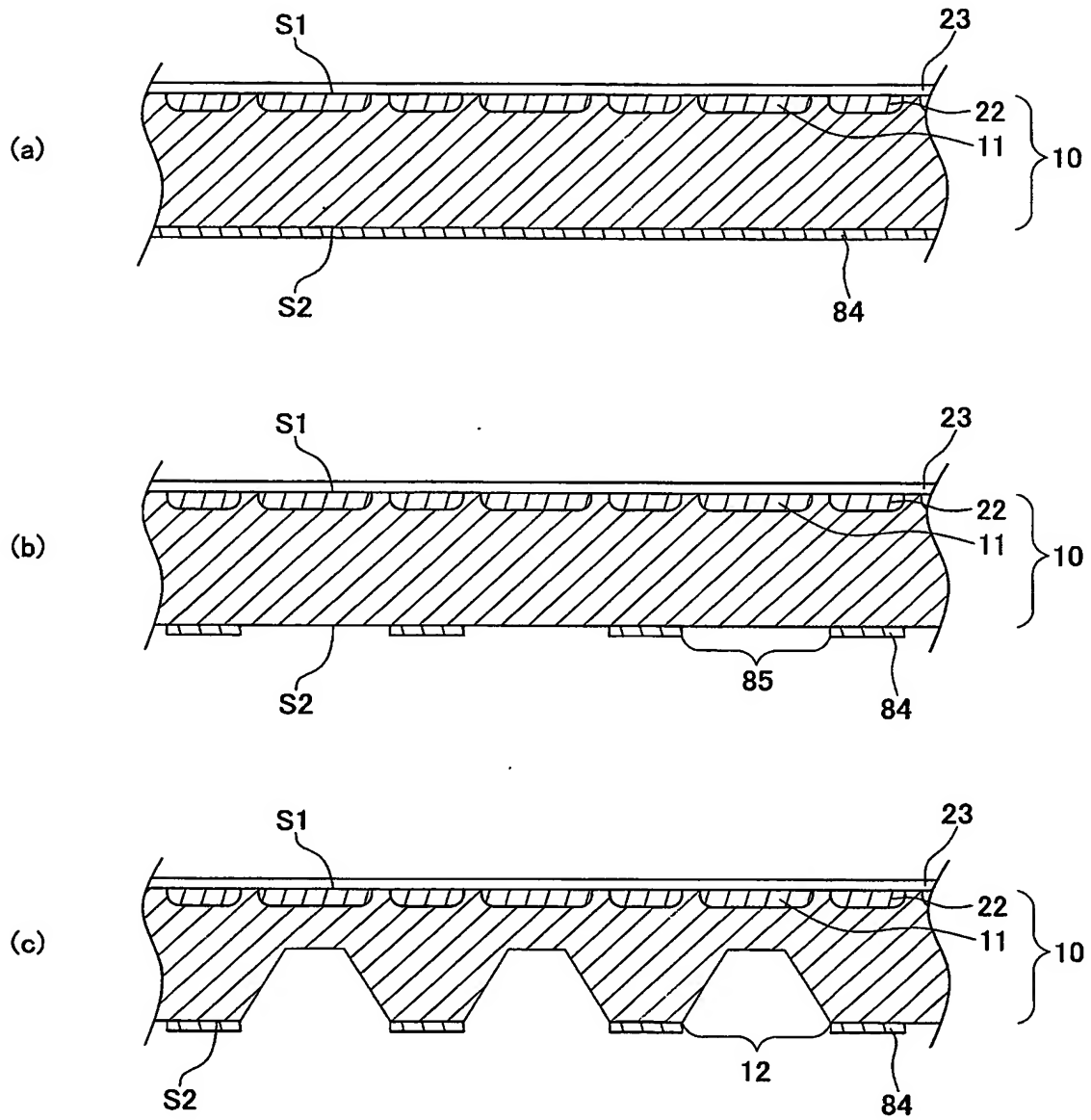
【図 3】



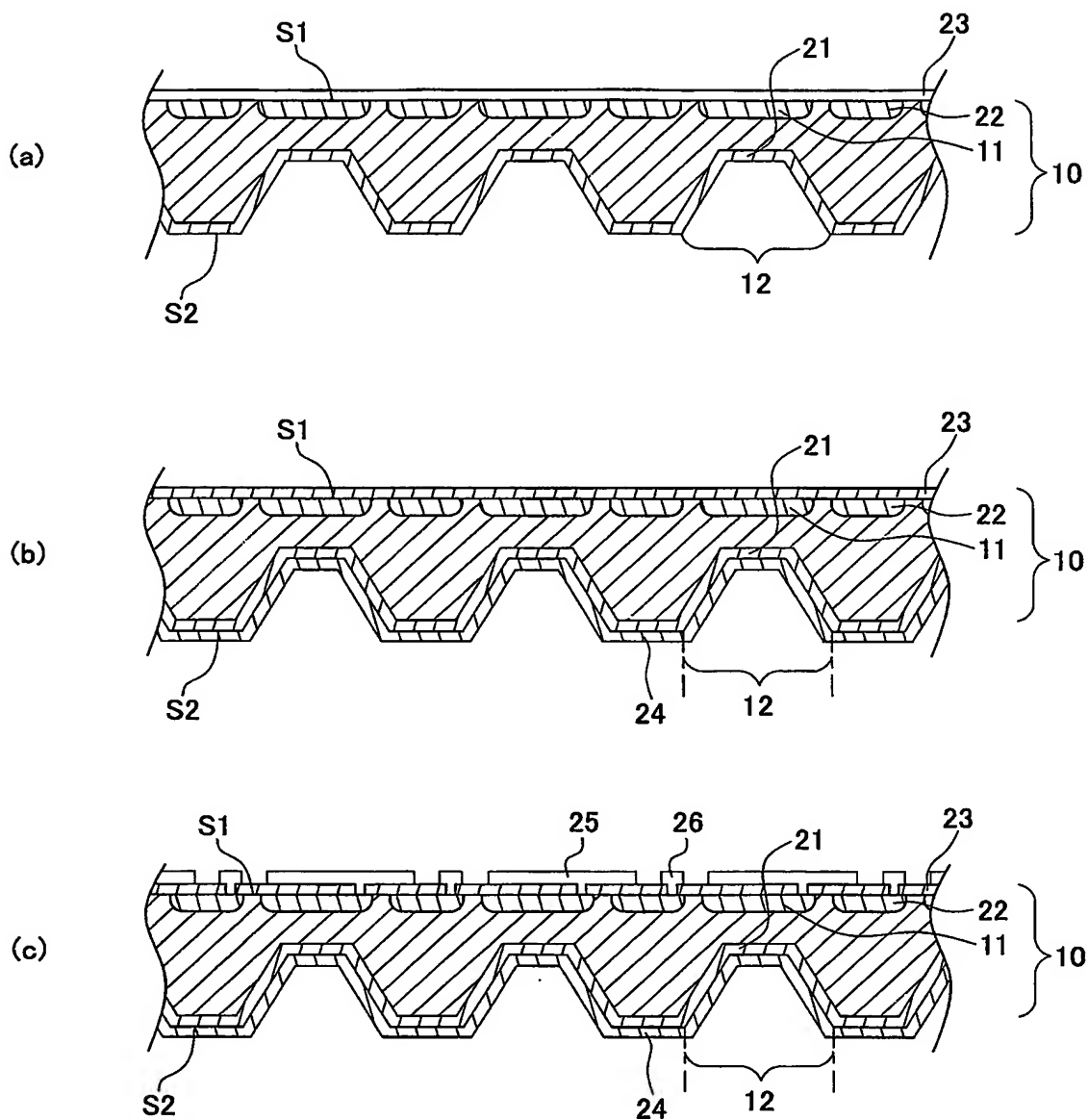
【図 4】



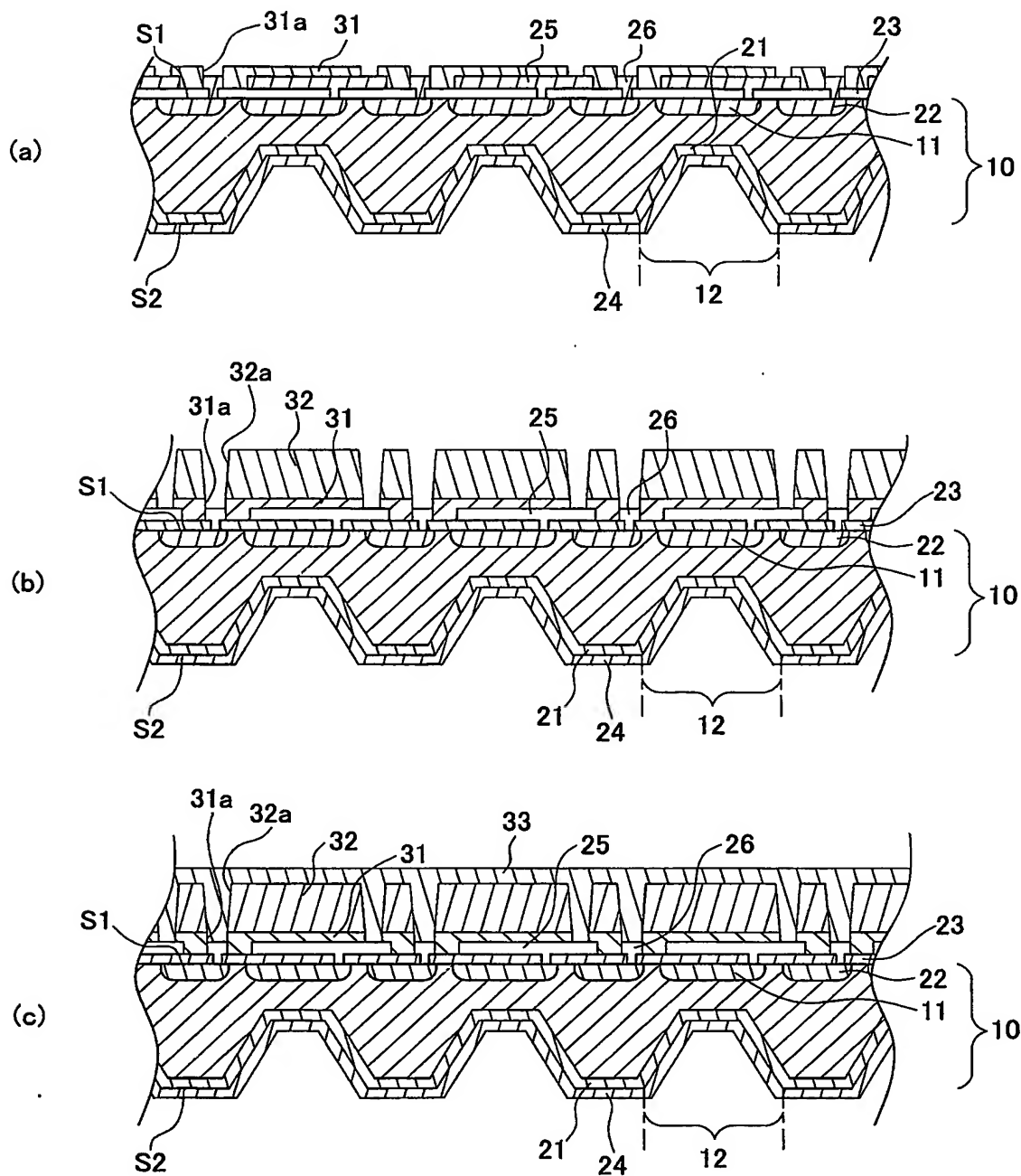
【図 5】



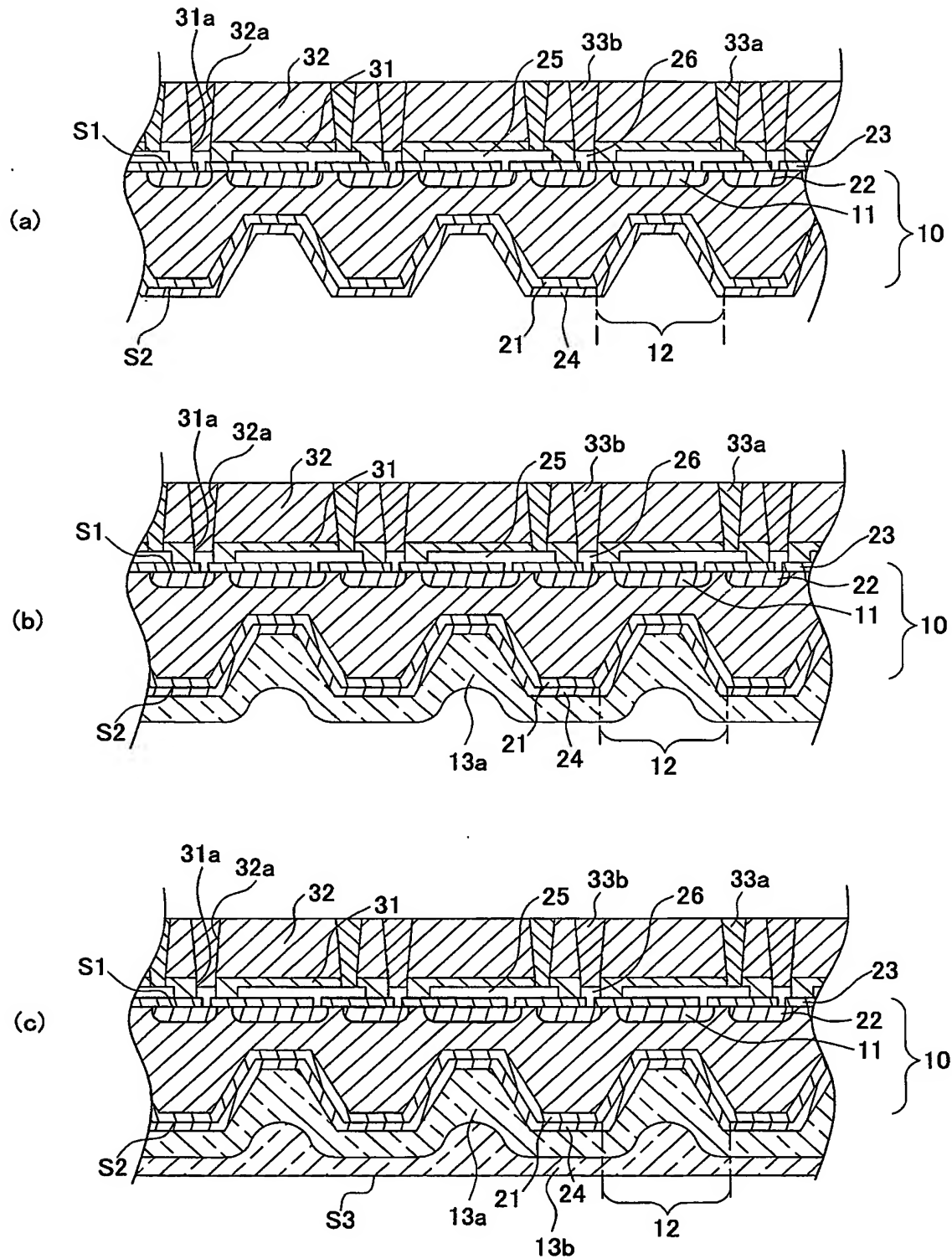
【図 6】



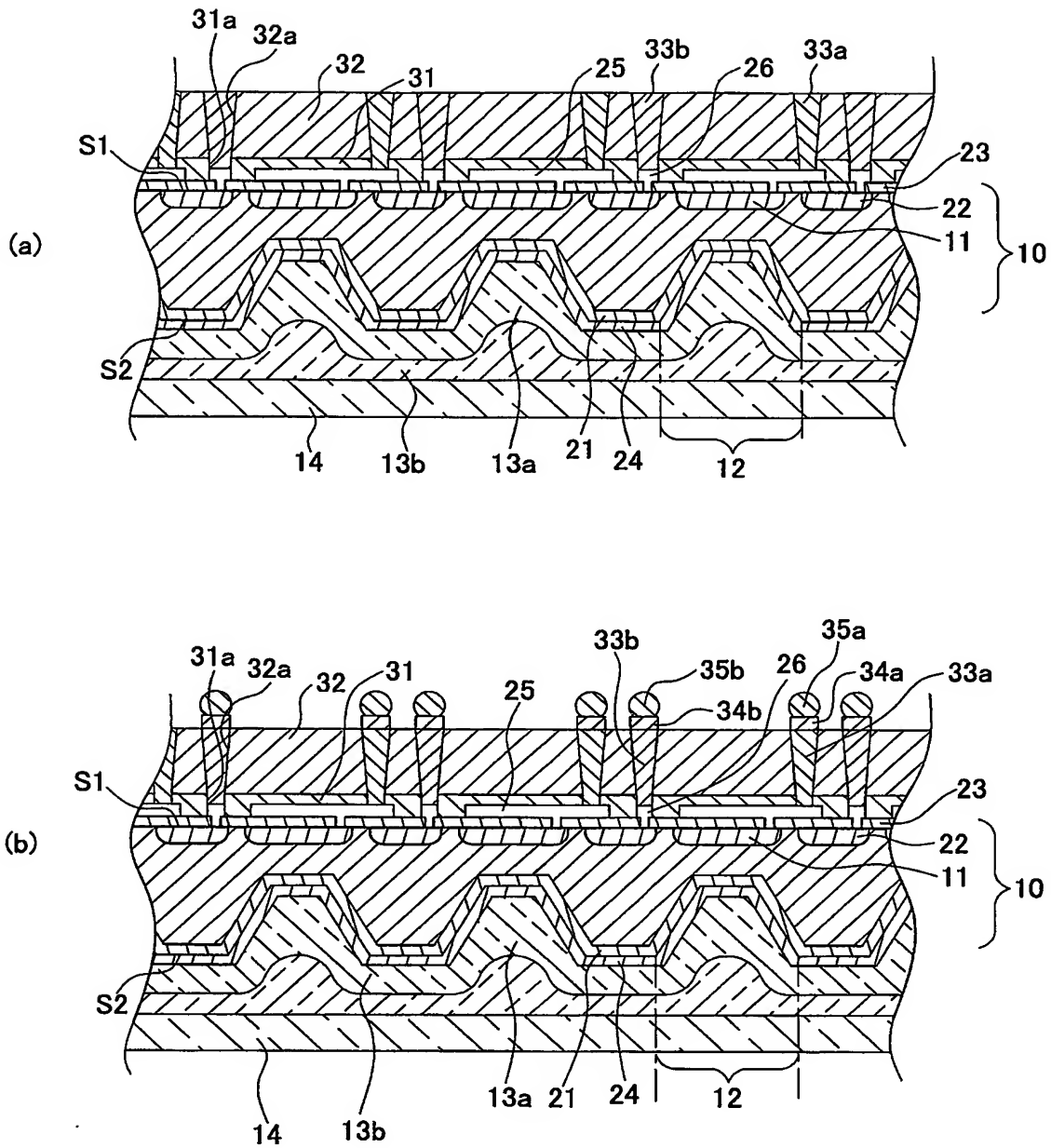
【図 7】



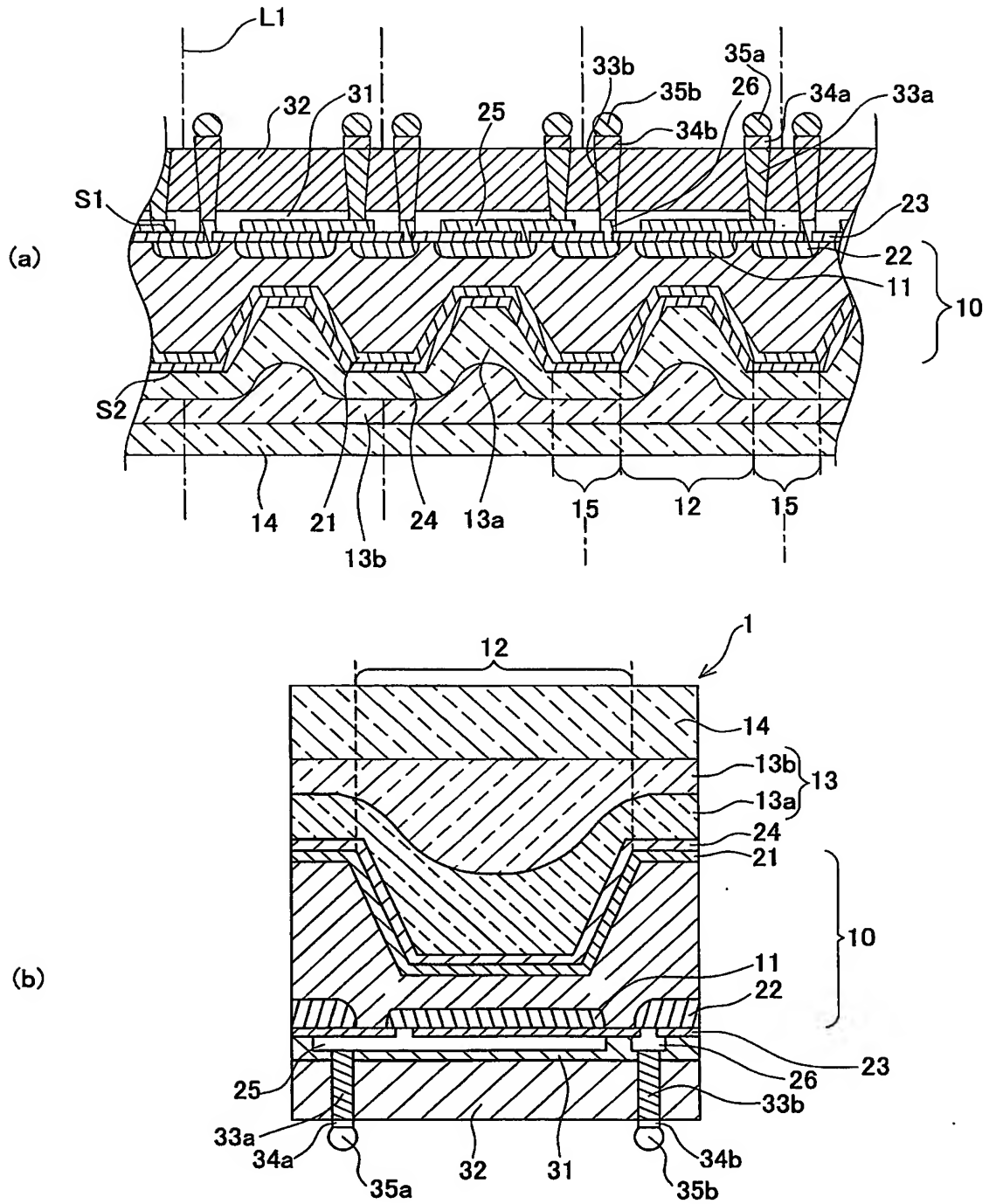
【図 8】



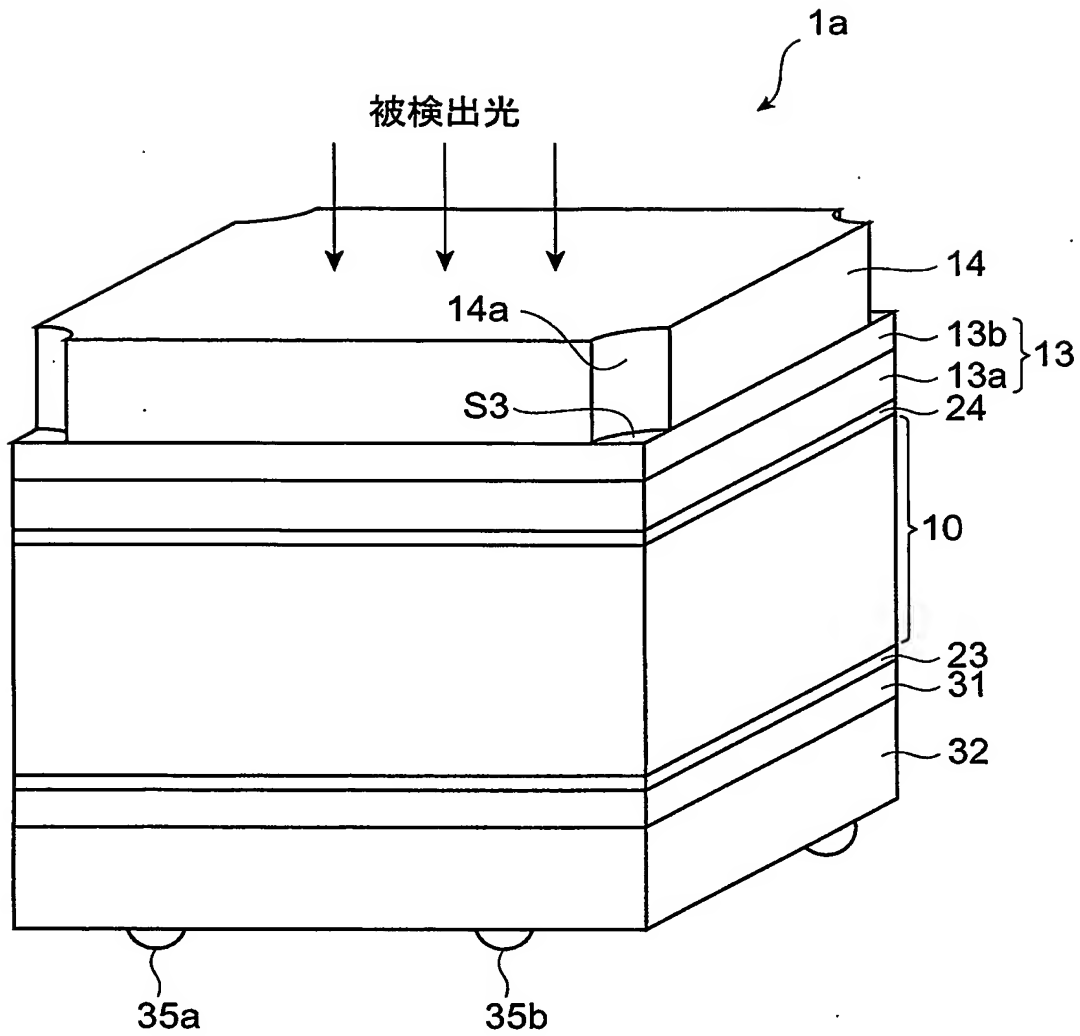
【図 9】



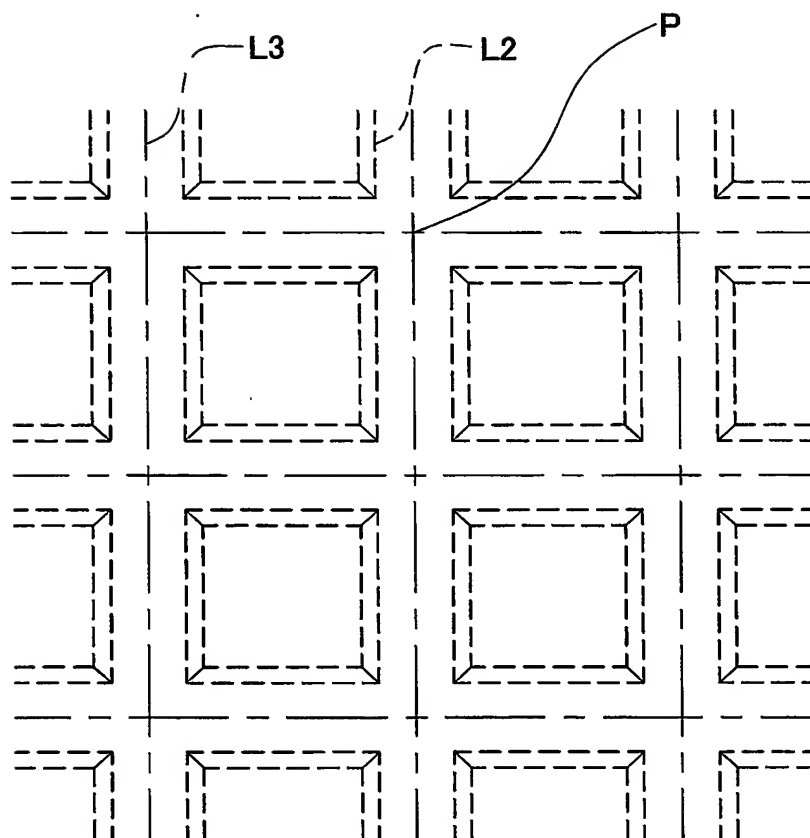
【図 10】



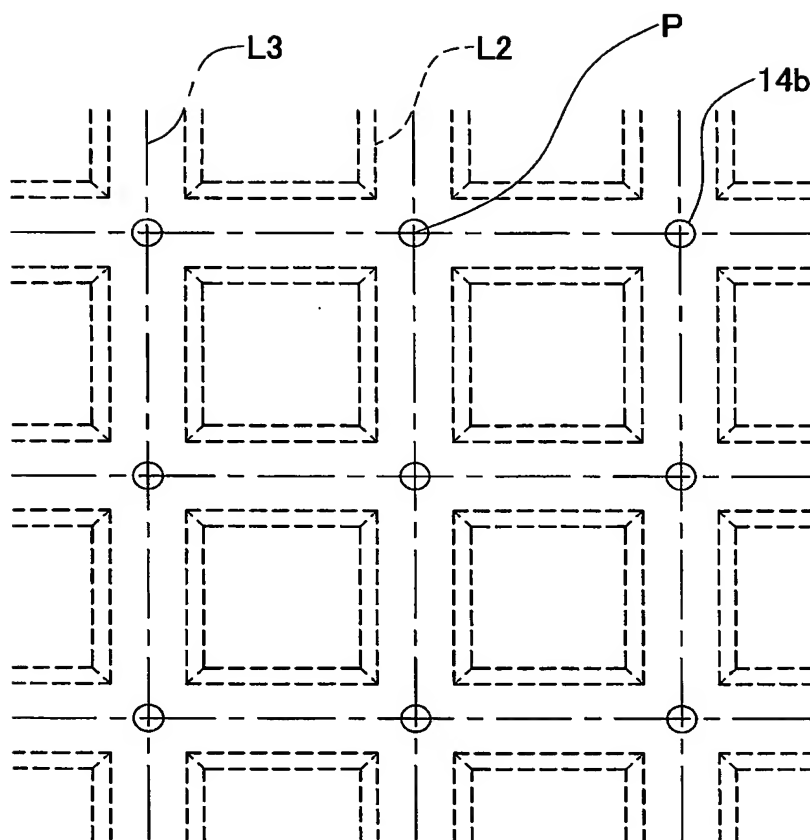
【図 11】



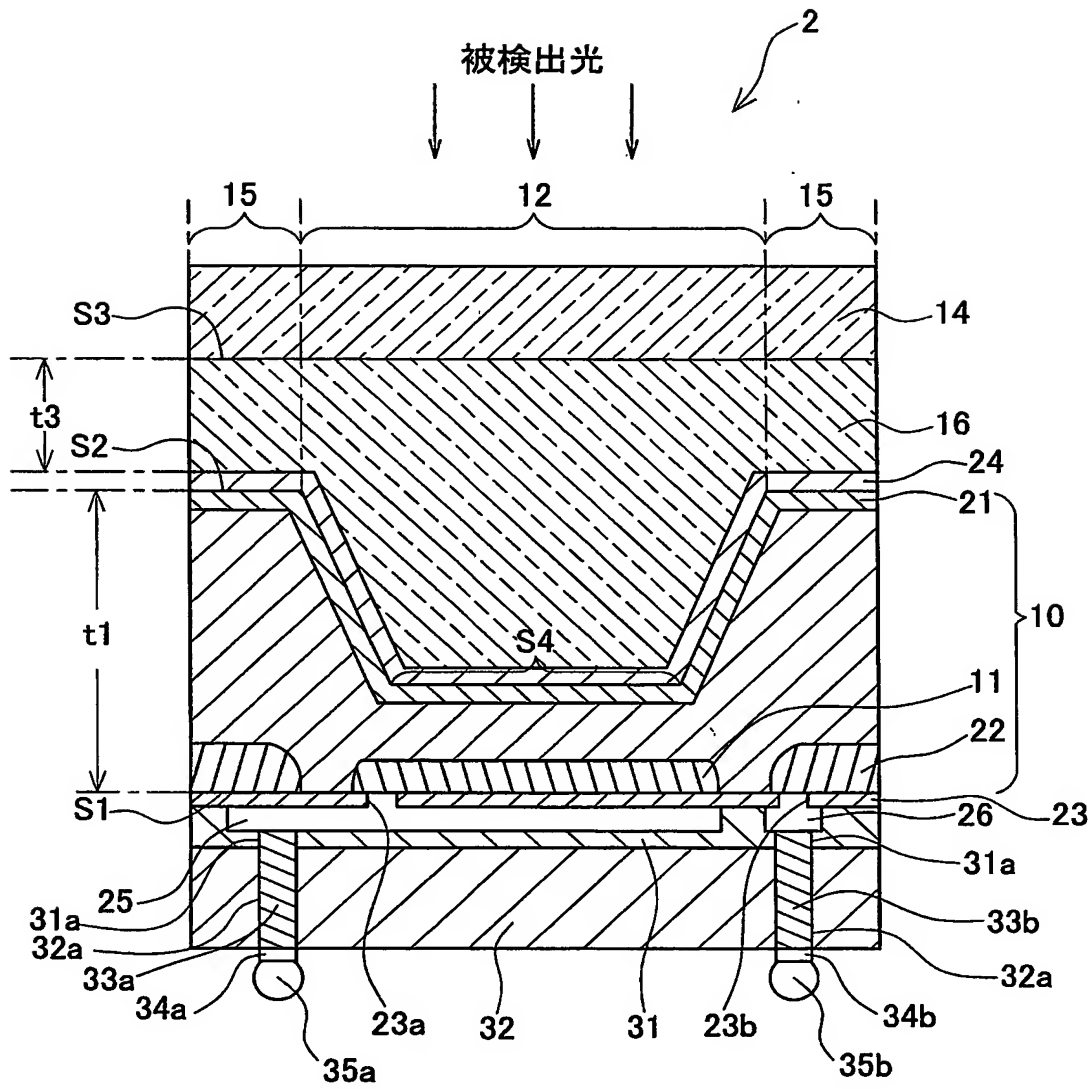
【図 12】



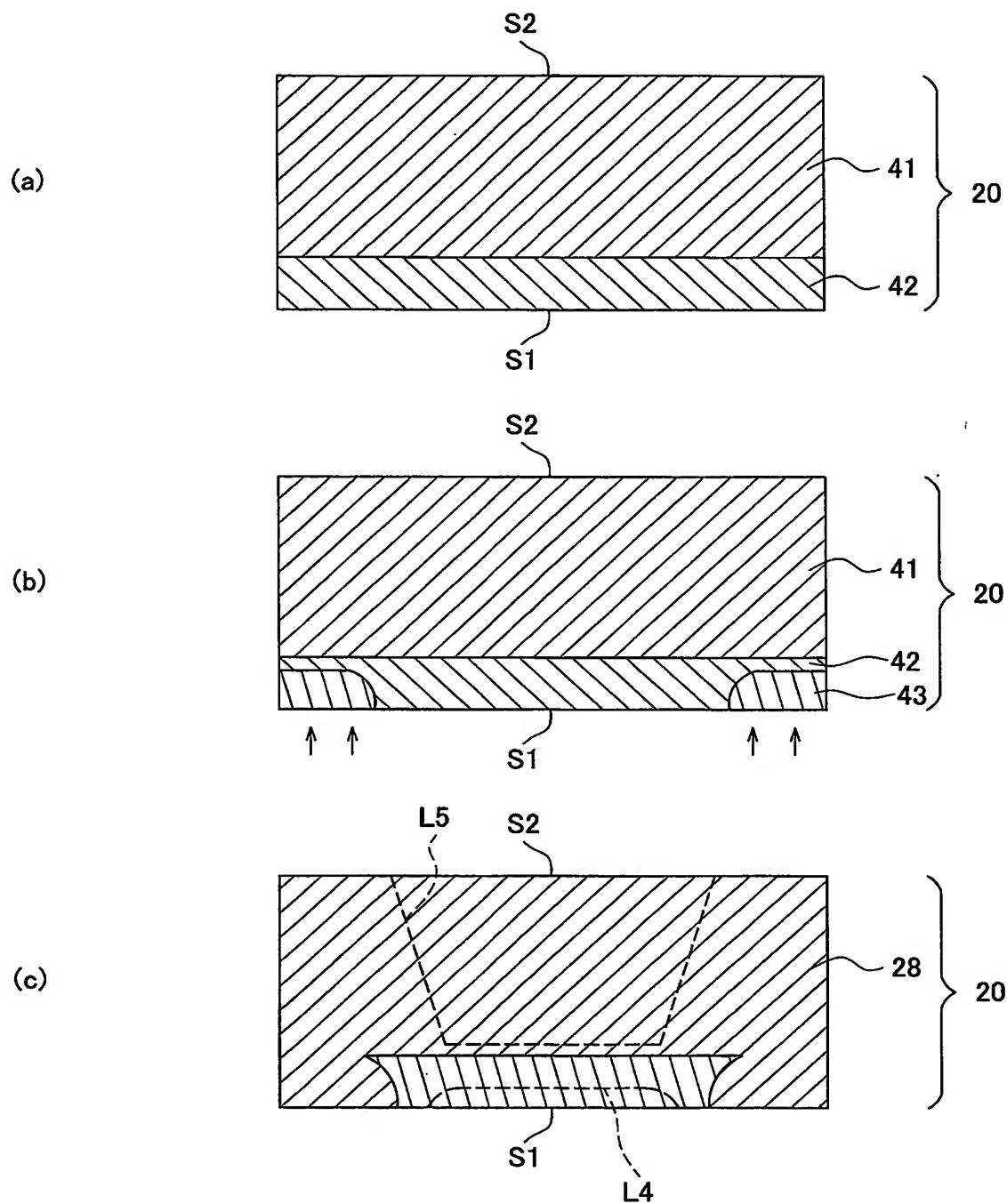
【図 13】



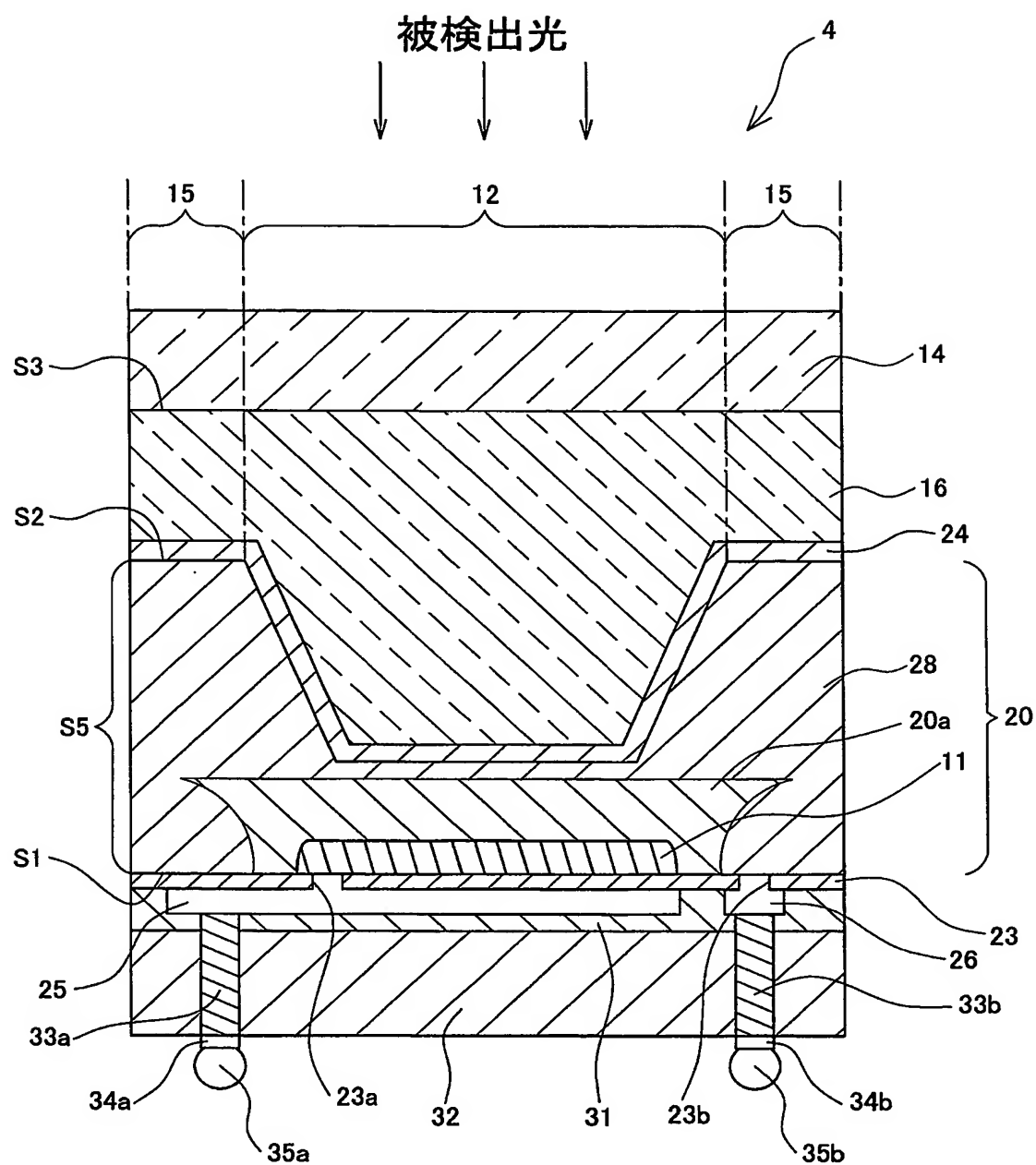
【図 14】



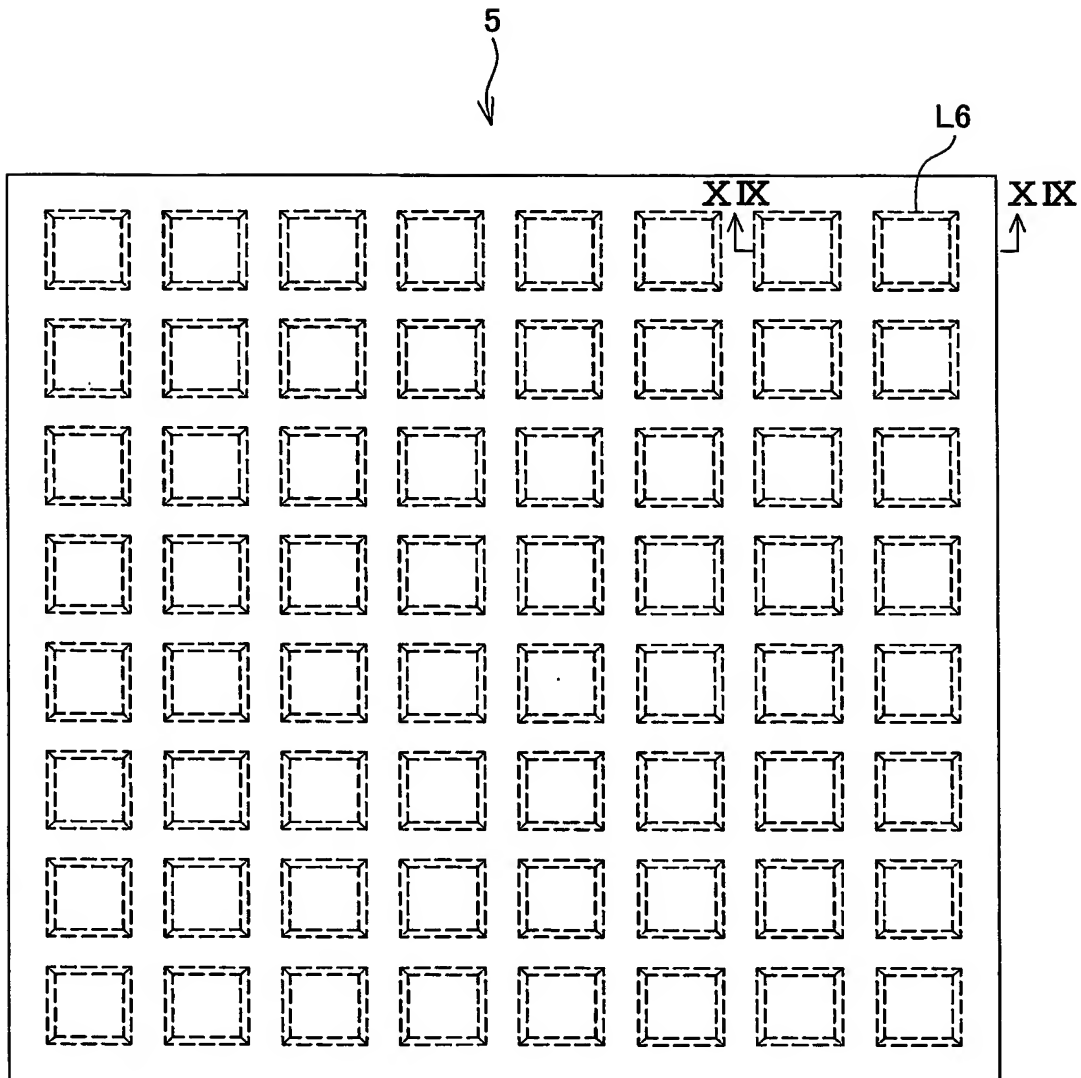
【図 16】



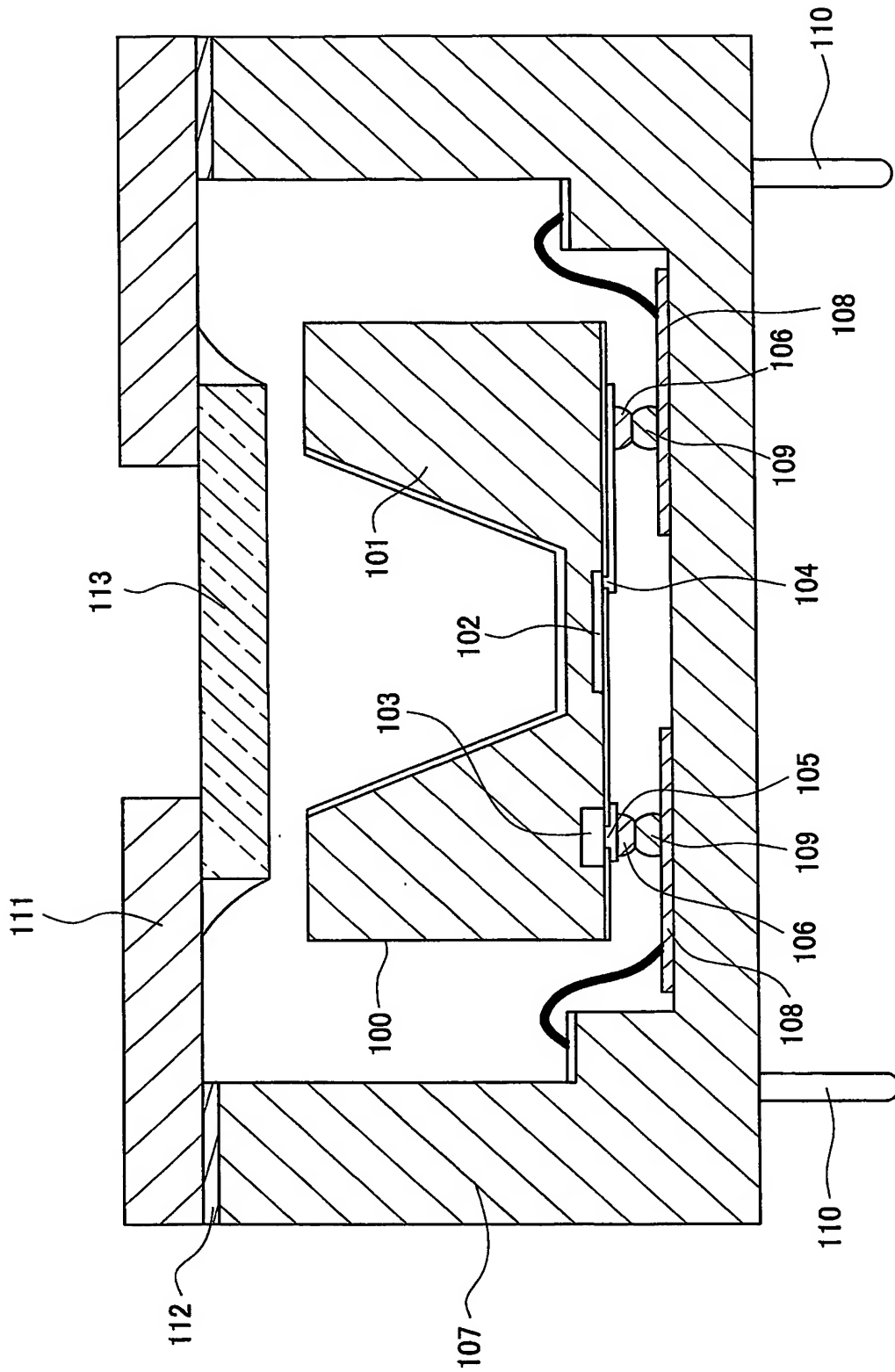
【図 17】



【図 18】



【図 20】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 パッケージを十分に小さくでき、且つ被検出光の散乱を抑制することができる裏面入射型光検出素子を提供する。

【解決手段】 裏面入射型ホトダイオード1は、N型半導体基板10、P⁺型不純物半導体領域11、凹部12、被覆層13、及び窓板14を備えている。N型半導体基板10の上面S1側における表層には、P⁺型不純物半導体領域11が形成されている。N型半導体基板10の裏面S2におけるP⁺型不純物半導体領域11に臨む領域には、被検出光の入射部となる凹部12が形成されている。また、N型半導体基板10の裏面S2上には、表面が実質的に平坦な被覆層13が設けられている。さらに、被覆層13上には、窓板が設けられている。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 3 - 2 8 2 1 6 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 3 6 4 3 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1

氏 名

浜松ホトニクス株式会社